

नोट्स

whatsapp

8696608541

अपडेटेड नोट्स

OM PRAKASH SAINI



notes (whatsapp) - 8696608541 (sbistudy.com)

इलेक्ट्रॉनिक युक्ति -

वे युक्तियाँ जो e^- नों के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहा जाता है तथा यह युक्तियाँ निम्न की प्रकार की होती हैं।

1. निर्वात नलिकाएँ
2. अर्द्धचालक युक्तियाँ

1. निर्वात नलिकाएँ -

ये नलिकाएँ काँच की बनी बड़ी-बड़ी नलिकाएँ होती हैं जिसके दोनो सिरे पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तथा यह निम्न प्रकार की होती हैं।

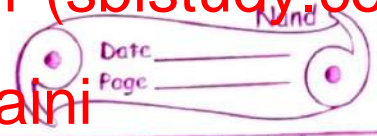
i) डायोड = डायोड + इलेक्ट्रोड - (एनोड, कैथोड)
दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बनी युक्ति डायोड कहलाती है।

ii) ट्रायोड = ट्रायोड + इलेक्ट्रोड (एनोड, ग्रिड, कैथोड) -
तीन इलेक्ट्रोडों से मिलकर बनी युक्ति ट्रायोड कहलाती है।

i) टेट्रोड ii) पेंटोड आदि

2. अर्द्धचालक युक्तियाँ -

वर्तमान में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को ही अर्द्धचालक युक्तियाँ कहा जाता है। इनमें एक छोटी सी चिप पर ही कई बि. अव्यव संरचित कर दिए जाते हैं।



* निर्वात नलिकाओं कि विशेषताये -

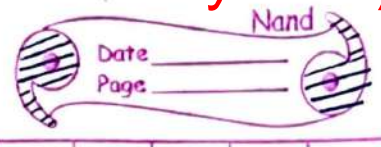
1. यह काँच की बनी बड़ी - बड़ी नलिकाये होती है। इस कारण इन्हे प्रचालित करने के लिए अधिक वोल्टता कि आवश्यकता होती है।
2. ये काँच कि बनी बड़ी - बड़ी नलिकाये होती है। इस कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना बल ले जाना कठिन होता है।
3. इन नलिकाओं का जीवन काल तथा विश्वसनीयता कम होती है।
4. ये नलिकाये आकार में - अत्यधिक बड़ी होती है। इस कारण यह अधिक स्थान घेरती है।

* अर्धचालक युक्तियों कि विशेषताये -

1. ये युक्तियाँ आकार में अत्यधिक छोटी होती है। इस कारण इन्हे प्रचालित करने के लिए बहुत ही कम वोल्टता कि आवश्यकता होती है।
2. ये आकार में अत्यधिक छोटी होती है। इस कारण इन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना बल ले जाना अधिक सरल होता है।
3. ये नलिकाये युक्तियाँ आकार में अत्यधिक छोटी होती है। इस कारण इन्हे रखने के लिए ज्यादा जगह कि आवश्यकता नहीं होती।
4. इन युक्तियों का जीवन काल एवं विश्वसनीयता ज्यादा होती है।

* पदार्थों का वर्गीकरण -

अर्धचालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते है। -



| | μ | σ |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. चालक पदार्थ | $10^{-2} - 10^{-8} \text{ cm}$ | $10^2 - 10^8 \text{ (mho/cm)}$ |
| 2. अर्धचालक पदार्थ | $10^{-6} - 10^5$ | $10^6 - 10^5$ |
| 3. कुचालक पदार्थ | $10^{11} - 10^{19}$ | $10^{-11} - 10^{-19}$ |

Note:- पदार्थों का वर्गीकरण चालकता के आधार पर कोई दृढ़ परास नहीं है इसके अलावा भी कई कारकों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जा सकता है।

* अर्धचालकों के प्रकार-
परमाणु की उपस्थिति के आधार पर अर्धचालक निम्न चार प्रकार के होते हैं -

1. तात्विक अर्धचालक -
वे अर्धचालक जो तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें तात्विक अर्धचालक कहा जाता है।
Ex. सिलिकन, जर्मेनियम etc.

2. अकार्बनिक अर्धचालक -
वे अर्धचालक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता उन्हें अकार्बनिक अर्धचालक कहा जाता है।
Ex. ~~Imp~~ Imp, Cds etc.

3. कार्बनिक अर्धचालक -
वे अर्धचालक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। इसे कार्बनिक अर्धचालक

कहा जाता है।

Ex. एन्प्रोसिन, मादितथैल्वो स्पामीन

4. बहुलक अर्द्धचालक -

वे अर्द्धचालक जो बहुलकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुलक अर्द्धचालक कहा जाता है।

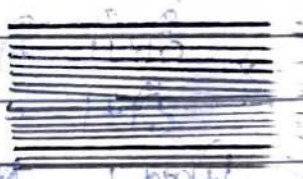
Ex. पॉलि एनिलीन, पॉलि थायोफिन,


* ठोसों में ऊर्जा बैंड अथवा ऊर्जा बैंड सिद्धान्त-

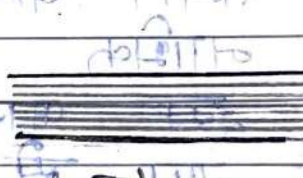
ठोस पदार्थ असंख्य अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा परमाणु में नाभिक के चारों ओर e^- वृत्तकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षाओं में $2n^2$ के नियम से भरा जाता है तथा जो e^- नाभिक के समीप वाले कक्षाओं में उपस्थित होते हैं उनपर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल लगता है। इस कारण इन e^- नों की बांधित e^- नों के नाम से जाना जाता है। तथा जो e^- नाभिक के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं उनपर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है। इस कारण इन e^- नों को प्रत्यक्ष चालक e^- या मुक्त e^- के नाम से जाना जाता है। तथा इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु में भिन्न- 2 ऊर्जा स्तरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के e^- पाये जाते हैं। अर्थात् परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। तथा जब यह विभिन्न ऊर्जा स्तरों के आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तो यह स्तर एक-दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं तथा इन स्तरों के अद्वारोपण से भी

ऊर्जा समूह प्राप्त होते हैं। उन ऊर्जा समूह को ही ऊर्जा बैंड कहा जाता है तथा इसे ही ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है।

3s बैंड 

2p बैंड 

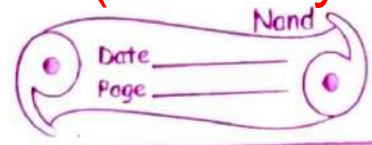
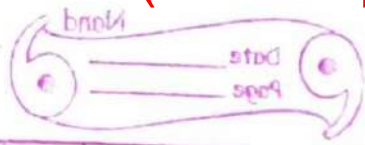
2s बैंड 

1s बैंड 

ऊर्जा बैंडों के प्रकार - ऊर्जा बैंड तीन प्रकार के होते हैं -

1. संयोजी ऊर्जा बैंड
2. चालन
3. वर्जित

1. संयोजी ऊर्जा बैंड - वेक e -एकजो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें प्र संयोजी e -क के नाम से जाना जाता है तथा यह संयोजी e -क जिन ऊर्जा स्तरों



में उपस्थित होते हैं। उन्हें संयोजी ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तथा इन संयोजी स्तरों के अध्यारोपण से जो ऊर्जा समूह प्राप्त होते हैं उन ऊर्जा समूहों को ही संयोजी ऊर्जा बैंड कहा जाता है। संयोजी ऊर्जा बैंड आंशिक रूप से भरे या पूर्ण रूप से भरे होते हैं।

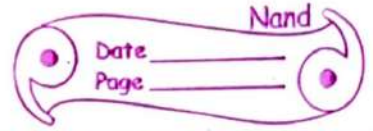
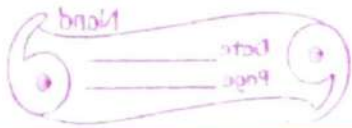
2. चालन ऊर्जा बैंड -

जब संयोजी ऊर्जा बैंड के e^- को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ये e^- ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर जाते हैं। अपरिचालन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। इन e^- को चालक e^- अर्थात् मुक्त e^- के नाम से जाना जाता है। तथा ये e^- जिन ऊर्जा स्तरों में पाये जाते हैं उन ऊर्जा स्तरों को चालन ऊर्जा स्तरों के नाम से जाना जाता है। तथा इन चालन ऊर्जा स्तरों के अध्यारोपण से संयोजी ऊर्जा समूह प्राप्त होते हैं। उन ऊर्जा समूहों को ही चालन ऊर्जा बैंड कहा जाता है।

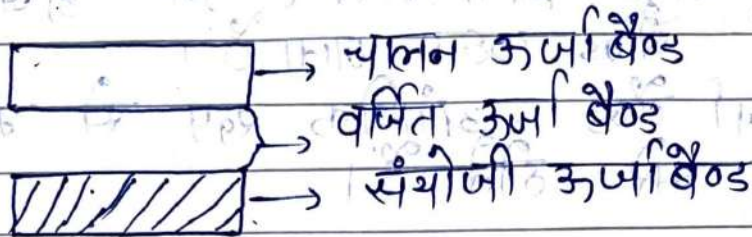
चालन ऊर्जा बैंड आंशिक रूप से भरे या पूर्ण रूप से खाली होते हैं।

3. वर्जित ऊर्जा बैंड -

संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के मध्य एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ e^- पाये जाने की प्रायिकता शून्य होती है। इन ऊर्जा स्तरों को वर्जित ऊर्जा स्तरों के नाम से जाना जाता है तथा इन वर्जित ऊर्जा स्तरों के अध्यारोपण से संयोजी ऊर्जा



समूह प्राप्त होते हैं। उन ऊर्जा समूहों को ही वर्जित ऊर्जा बैंड कहा जाता है।



* ऊर्जा बैंडों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण -
ऊर्जा बैंडों के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं।

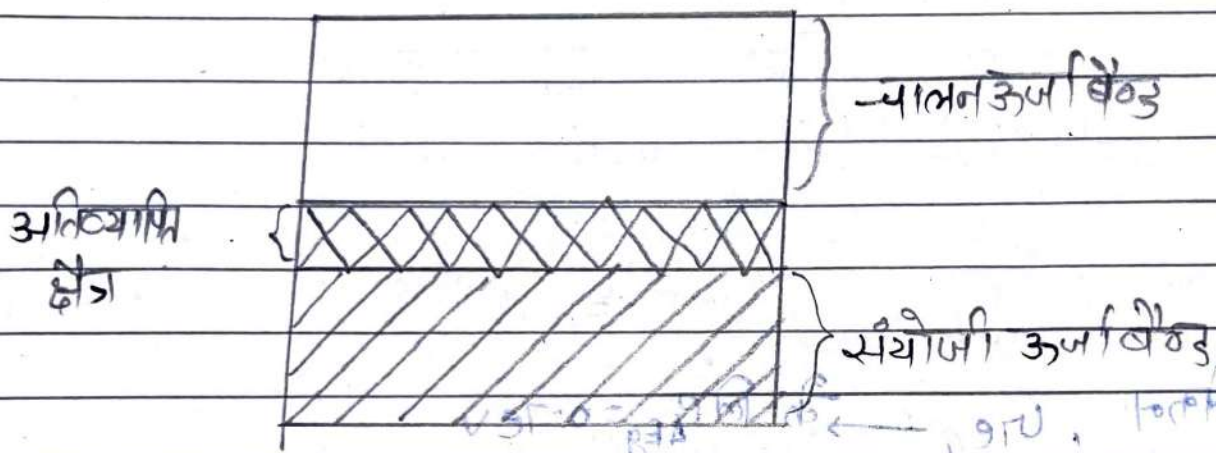
1. चालक पदार्थ
2. अर्धचालक पदार्थ
3. कुचालक पदार्थ

1. चालक पदार्थ -
वे पदार्थ जिनमें संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड एक-दूसरे से अतिव्यापित होते हैं। अर्थात् जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है। उन्हें चालक पदार्थों के नाम से जाना जाता है। इनमें संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड एक-दूसरे से अतिव्यापित होने के कारण आसानी से संयोजी ऊर्जा बैंड के e^- चालन ऊर्जा बैंड में प्रवेश कर जाते हैं जिससे ये पदार्थों का चालन करने लगते हैं तथा इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है। जिससे इनके प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होती है और चालकता के मान में कमी होती है। इन पदार्थों

के प्रतिरोध कि ताप पर निर्भरता को निम्न सूत्र कि सहायता से प्रदर्शित किया जाता है।

$$R_t = R_0 (1 + \alpha \Delta t)$$

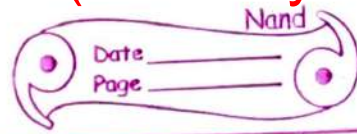
इन पदार्थों के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक का मान धनात्मक होता है।



Eg. सोना, चाँदी, लोहा

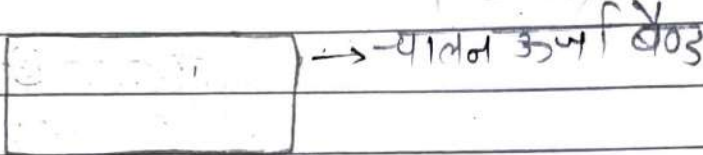
२. अर्द्धचालक पदार्थ -

ये पदार्थों में विद्युत ऊर्जा अंतराल का मान 0.5 eV से 2 eV के बीच होता है। तथा जो ताप बढ़ाने पर चालकता प्रदर्शित करते हैं उन्हें अर्द्धचालक पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड एक दूसरे के समीप आने लगते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा अंतराल के मान में कुछ कमी होने लगती है तथा संयोजी ऊर्जा बैंड के e^- चालन ऊर्जा बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और चालकता बढ़ती है। इन पदार्थों के प्रतिरोध कि ताप पर निर्भरता को निम्न सूत्र कि सहायता से प्रदर्शित किया जाता है।

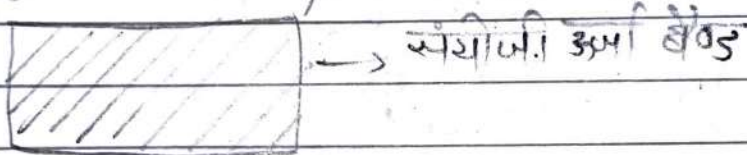


$$R_t = R_0 (1 + \alpha \Delta t)$$

इन पदार्थों के ताप प्रतिरोध गुणों का मान ऋणात्मक होता है अर्थात् ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में कमी होती है।



$\Delta E_g = 0.5 \text{ eV to } 2.5 \text{ eV}$ वर्जित ऊर्जा बैंड



Eg. सिलिकन, Ge के लिए $\Delta E_g = 0.7 \text{ eV}$
 \downarrow , GaAs के लिए $\Delta E_g = 1.53 \text{ eV}$
 $\Delta E_g = 1.1 \text{ eV}$

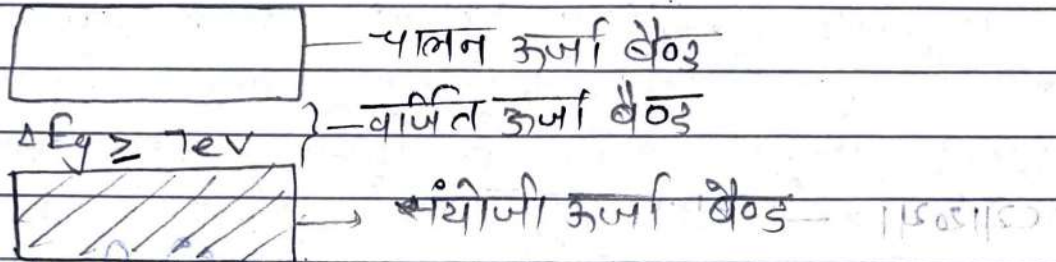
3. कुचालक पदार्थ-

वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अन्तराल का मान 7 eV या इससे अधिक होता है उन्हें कुचालक पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर भी संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड एक-दूसरे के समीप आने लगते हैं लेकिन इन पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अन्तराल को समाप्त करने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है तथा इतने अधिक ताप को यह पदार्थ सहन नहीं कर पाते। जिसके कारण ये कोई धारा का चालन नहीं करते। तथा इन पदार्थों की प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता को निम्न समी. कि

सहायता से प्रदर्शित किया जाता है।

$$R_t = R_0(1 + \alpha \Delta T)$$

इन पदार्थों के ताप प्रतिरोध गुणांक का मान भी ऋणात्मक होता है।



Ex. हीरा के लिए $\Delta E_g = 7eV$

* अर्द्धचालकों के प्रकार - अर्द्धचालक तत्वों या परमाणुओं के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।

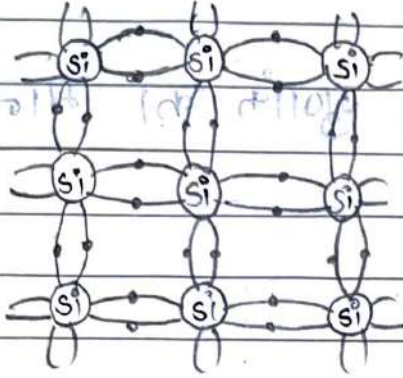
1. शुद्ध या नेच अर्द्धचालक
2. निःषाध्य अर्द्धचालक अपद्वयी प्रादि।

* 1. शुद्ध या नेच अर्द्धचालक - ये अर्द्धचालक जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध या नेच अर्द्धचालक कहा जाता है। इन अर्द्ध

Ex. Si, Ge अर्द्धचालक एल।

इन अर्द्धचालकों की चालकता कि ताप पर निर्भरता को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है -

i) परम शून्य ताप (0K) पर रखने पर -



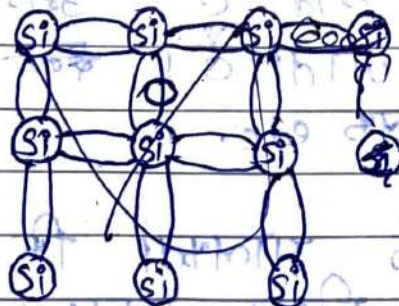
$$n_e = 0, n_H = 0$$

$$n_e = n_H = 0$$

व्याख्या -

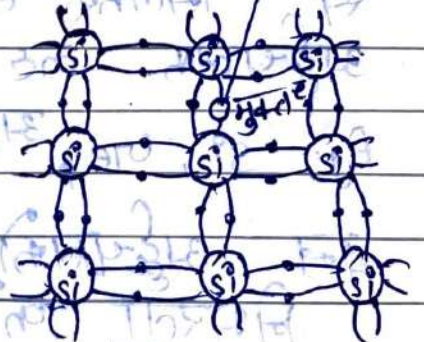
इस परमाणु एक चतुसंयोजी परमाणु होता है। ये अपने समीप स्थित चार Si परमाणु के साथ एकल सहसंयोजक बंध बना लेता है तथा ये बंध इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि परमशून्य ताप पर कोई भी बंध नहीं टूटता है जिसके कारण इस स्थिति में कोई मुक्त आवेशवाहक (मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोटर) उपस्थित नहीं होता जिसके कारण इस स्थिति में कोई धारा का पालन नहीं कर पाते। और कुचालक पदार्थों की भाँति व्यवहार करते हैं।

ii) कमरे के ताप पर रखने पर -



$$n_e = 0, n_H > 0$$

$$n_e = n_H > 0$$



व्याख्या -

जब शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों को कमरे के ताप पर रखा जाता है तो इनमें तापीय हलचल होने के कारण इनका एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है जिससे इसमें से एक e^- बाहर आ जाता है जो कि मुक्त e^- कि भाँति व्यवहार करता है तथा इसके स्थान पर एक रिक्त स्थान उपास्थित हो जाता है जिसे हॉल या कौटर के नाम से जाना जाता है तथा इस स्थिति में इनमें दोनों प्रकार के आवेश वाहक (मुक्त e^- तथा हॉल या कौटर) उपास्थित होते हैं जिसके कारण इस स्थिति में यह धारा का चालन करने लगते हैं। अर्थात् इस स्थिति में यह चालकी - कि भाँति व्यवहार करने लगते हैं।

* शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों का गणितीय विश्लेषण -

माना शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n_e तथा हॉल या कौटर संख्या घनत्व n_h है तथा e^- नों पर आवेश का मान q_e व हॉल या कौटर पर आवेश का q_h तथा इनके अपवाह वेगों के मान क्रमशः v_{e1} व v_{h1} है तो इस स्थिति में शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों के धारा घनत्व का मान -

विद्यारा के अपवाह वेग के से संबंध से -

$$I = neAv_d$$

$$I = nevd$$

A

$$\therefore \frac{I}{A} = J$$

$$J = nev_d \quad \text{--- (1)}$$

$$(2) \rightarrow J_{total} = J$$

अतः हील ०० कौटर के लिए द्वारा धनत्व

$$\vec{J}_H = n_H q_H \vec{v}_H \quad \text{--- ①}$$

इसी प्रकार मुक्त e- के लिए द्वारा धनत्व

$$\vec{J}_e = n_e q_e \vec{v}_e \quad \text{--- ②}$$

अतः शुद्ध ०० नैज अर्द्ध-चालको का द्वारा धनत्व :-

$$\vec{J} = \vec{J}_e + \vec{J}_H$$

समी. ① व ② से :-

$$\vec{J} = n_e q_e \vec{v}_e + n_H q_H \vec{v}_H \quad \text{--- ③}$$

शुद्ध नैज अर्द्ध-चालको के लिए -

$$\therefore n_e = n_H$$

$$\therefore q_e = q_H$$

समी. ③ से

$$\vec{J} = n_e q_e \vec{v}_e + n_e q_e \vec{v}_H$$

$$\vec{J} = n_e q_e (\vec{v}_e + \vec{v}_H) \quad \text{--- ④}$$

इस राशियती में जब शुद्ध या नैज अर्द्ध-चालको के सिरे पर बाह्य वोल्टता आरोपित की जाती है। तो इनमे वि. क्षेत्र उत्पन्न होता है इस राशियती में अपवाह वेग वि. क्षेत्र के समानुपाती होता है अर्थात् -

$$\therefore \vec{v}_e \propto \vec{E} \text{ से}$$

e- के लिए

$$\vec{v}_e \propto \vec{E} \quad \text{--- ⑤}$$

$$\vec{v}_e = \mu_e \vec{E} \quad \text{--- ⑥}$$

जिनमें परमाणुओं की गतिशीलता

$$\mu_e = e^-$$

इसी प्रकार हील व कोटर के लिए -

$$\vec{J}_H \propto \vec{E}$$

$$\vec{J}_H = \mu_H \vec{E} \quad \text{--- (7)}$$

अतः समी. (7) से -

$$\vec{J} = neve (\mu_e \vec{E} + \mu_H \vec{E})$$

$$\vec{J} = neve (\mu_e + \mu_H) \vec{E} \quad \text{--- (8)}$$

ओम के सदिश निरूपण से -

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \text{--- (9)}$$

समी. (8) व (9) की तुलना करने पर -

$$\sigma = neve (\mu_e + \mu_H) \quad \text{--- (10)}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad \text{से}$$

$$\rho = \frac{1}{neve (\mu_e + \mu_H)} \quad \text{--- (11)}$$

* अ: बाह्य या अपद्रवी अर्द्धचालक -

वे अर्द्धचालक जिनमें त्रिसंयोजी तथा पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिली होती है उन अर्द्धचालकों को ही बाह्य या अपद्रवी अर्द्धचालक कहा जाता है।

Note:- शुद्ध या वैज अर्द्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है इनकी चालकता को बढ़ाने के

लिए ही इनमे त्रिसंयोजी अथवा पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। यही अपमिश्रण करने का - लाभ है।

बाह्य या अपद्रवी अर्द्धचालकों के प्रकार -

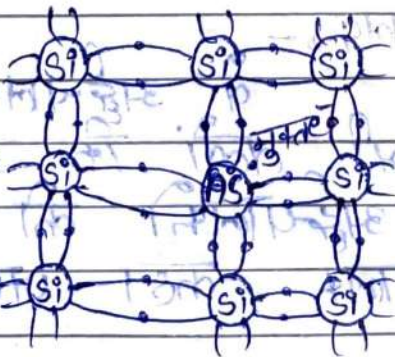
आधार पर बाह्य या अपद्रवी अर्द्धचालक दो प्रकार के होते हैं।

- i) n- प्रकार के अर्द्धचालक
- ii) p- प्रकार के अर्द्धचालक

i) n- प्रकार के अर्द्धचालक -

जब शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों में पंचसंयोजी तत्व जैसे - As फास्फोरस आदि की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार के अर्द्धचालकों को n- प्रकार के अर्द्धचालक कहा जाता है तथा इन अर्द्धचालकों की चालकता कि ताप पर निर्भरता की निम्न प्रकार समझाया जा सकता है।

a) परमशून्य ताप पर रखने पर (0K) -



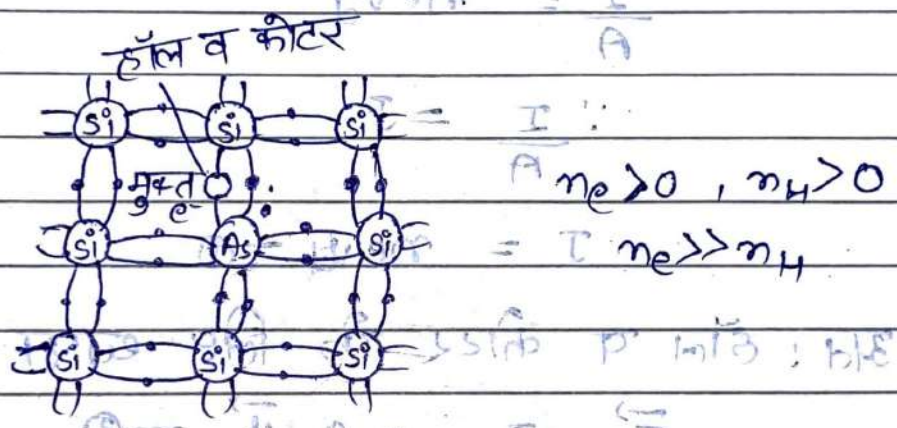
$$n_e > 0, n_h = 0$$

$$n_e > n_h$$

व्याख्या -

जब Si अर्द्धचालक में पंचसंयोजी तत्व आर्सेनिक कि अशुद्धि मिलाई जाती है तो ये अपने समीप स्थित P सिलिकन परमाणुओं के साथ एकल सहसंयोजक बंध बना लेता है लेकिन फिर भी इसका पॉपवॉल्टेज शेष रह जाता है जो कि मुक्त e^- की भाँति व्यवहार करता है जिसके कारण इस स्थिति में यह धारा का चालन करते हैं अर्थात् यह चालक पदार्थों की भाँति व्यवहार करता है।

b.) कमरे के ताप पर रखने पर -



व्याख्या -

जब As प्रकार के अर्द्धचालक को कमरे के ताप पर रखा जाता है तो इनमें तापीय उत्सर्जन होने के कारण एकल संयोजक बंध टूट जाता है जिससे मुक्त e^- के प्रत्येक As के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस स्थिति में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में e^- ही होते हैं। जिसके कारण ये धारा का चालन करने लगते हैं।

N-प्रकार के अर्द्धचालको का ठाणित्तीय विश्लेषण -
मान N-प्रकार के अर्द्धचालको में e^- संख्या घनत्व n_e तथा हॉल या कोटर संख्या घनत्व n_h हैं। जबकि e^- नों पर आवेश का मान q_e तथा हॉल या कोटर पर आवेश का मान q_h हैं। इनके अपवाह वेगों के मान क्रमशः v_e व v_h हैं। तो इस स्थिति में N-प्रकार के अर्द्धचालको में धारा घनत्व का मान -

वि. धारा व अपवाह वेग के सम्बन्ध से -

$$I = n_e A v_e$$

$$\frac{I}{A} = n_e v_e$$

$$\therefore \frac{I}{A} = J$$

$$J = n_e v_e \quad \text{--- (1)}$$

अतः हॉल व कोटर के लिए धारा घनत्व -

$$J_h = n_h q_h v_h \quad \text{--- (2)}$$

इसी प्रकार मुक्त e^- के लिए धारा घनत्व -

$$J_e = n_e q_e v_e \quad \text{--- (3)}$$

अतः N-प्रकार के अर्द्धचालको के लिए -

$$J = J_e + J_h$$

समी. (2) व (3) से -

$$J = n_e q_e v_e + n_h q_h v_h \quad \text{--- (4)}$$

\therefore N-प्रकार के अर्द्धचालको के लिए -

$$\therefore n_e \gg n_h$$

$$q_e = q_m$$

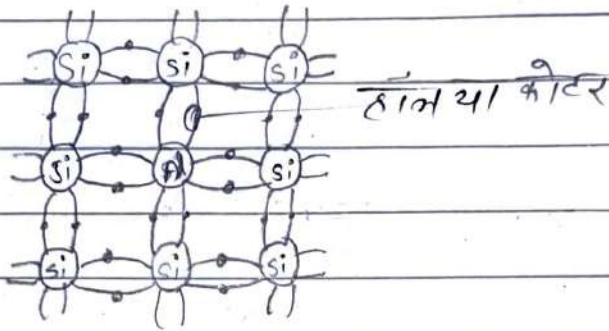
$$0 < q_m < q_e$$

वैद्युत क्षेत्र की एक विशेषता है कि वह एक सदिश क्षेत्र है। इसका मतलब है कि हम किसी बिंदु पर किसी दिशा में एक इकाई धन आवेश को रख सकते हैं और उस बिंदु पर उस दिशा में एक इकाई वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह क्षेत्र बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न होता है।

ii) p-प्रकार के अर्द्धचालक - जब शुद्ध या नेच अर्द्धचालकों में प्रिसंयोजी तत्व जैसे - B, Al, In आदि की अशुद्ध मिला दी जाती है तो इस प्रकार के अर्द्धचालकों को p-प्रकार के अर्द्धचालकों के नाम से जाना जाता है।

इन अर्द्ध-चालकों कि चालकता की ताप पर निर्भरता को निम्न प्रकार समाझा जा सकता है।

a.) परमशून्य ताप पर रखने पर (0K) -



$$n_H > 0, n_e = 0$$

$$n_H > n_e$$

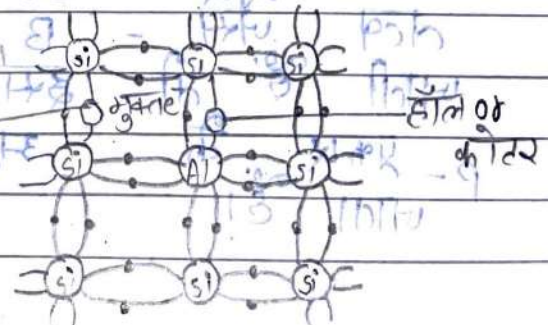
व्याख्या -

जब अर्द्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व कि अशुद्धि मिलाई जाती है तो यह अपने समीप स्थित तीन सिलिकन परमाणुओं के साथ तीन सहसंयोजक बंध बना लेता है। लेकिन इसका एक परमाणु शेष रह जाता है जिसके कारण इस स्थिति में इसमें एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है जिसे हॉल या कौटर के नाम से जाना जाता है तथा इस स्थिति में इनमें हॉल या कौटर ही आवेश वाहकी के रूप में काम करते हैं जिसके कारण इस स्थिति में यह इन्ही के कारण चालकता का चालन करने लगते हैं।

ii) कमरे के ताप पर रखने पर -

$$n_H > 0, n_e > 0$$

$$n_H >> n_e$$



व्याख्या -

जब p-प्रकार के अर्धचालकों को कमरे ताप पर रखा जाता है तो इनमें तापीय हलचल होने के कारण इनका एकल सहसंयोजक बंध टूट जाता है जिसके कारण इसमें से एक e- बाहर आ जाता है तथा इसके स्थान पर एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसे हॉल या कौटर के नाम से जाना जाता है तथा इस स्थिति में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में हॉल या कौटर ही होते हैं जिनके कारण यह धारा का चालन करने लगते हैं।

* p-प्रकार के अर्धचालकों का गणितीय विश्लेषण -

माना p-प्रकार के अर्धचालकों में e- संख्या घनत्व n_e तथा हॉल या कौटर का संख्या घनत्व n_h है। जबकि n_e पर आवेश का मान q_e तथा हॉल या कौटर पर आवेश का मान q_h है इनके अपवाह वेगों के मान क्रमशः v_e व v_h हैं तो इस स्थिति में p-प्रकार के अर्धचालकों के लिए -

वि० धारा व अपवाह वेग के संबंध से -

$$I = neAv_d$$

$$I = n_h v_h A$$

$$\frac{I}{A} = J$$

$$J = n_e v_d \quad \text{--- (1)}$$

अतः हॉल व कौटर के लिए धारा घनत्व -

$$J_h = n_h q_h v_h \quad \text{--- (2)}$$

इसी प्रकार मुक्त e- के लिए धारा घनत्व -

$$\vec{j}_e = neqv_e \vec{v}_e \quad \text{--- (3)}$$

अतः p-प्रकार के अर्द्धचालकों के लिए-

$$\vec{j} = \vec{j}_e + \vec{j}_H$$

समी. (2) व (3) से -

$$\vec{j} = neqv_e \vec{v}_e + n_H q_H \vec{v}_H \quad \text{--- (4)}$$

p-प्रकार के अर्द्धचालकों के लिए -

$$n_H \gg n_e$$

$$\vec{j} = n_H q_H \vec{v}_H \quad \text{--- (5)}$$

→ ∴ $\vec{j} = \mu_H q_H E$ से -

हॉल कोटर के लिए -

$$\vec{j}_H = \mu_H E$$

$$\vec{j} = \mu_H E \quad \text{--- (6)}$$

समी. (5) से -

$$\vec{j} = n_H q_H \mu_H E \quad \text{--- (7)}$$

उपरोक्त के सदिश निरूपण से -

$$j = \sigma E$$

समी. (7) व (6) की तुलना करने पर

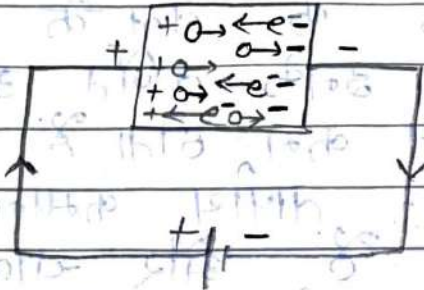
$$\sigma = n_H q_H \mu_H \quad \text{--- (8)}$$

$$\therefore \rho = \frac{1}{\sigma} \text{ से}$$

$$\rho = \frac{1}{n_H q_H \mu_H}$$



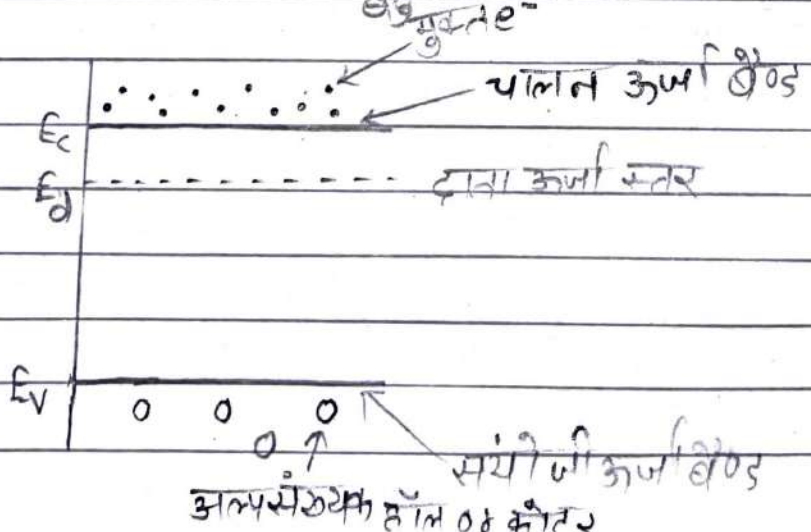
* अर्धचालकों में धारा प्रवाह -



जब किसी अर्धचालक को किसी बैटरी से संयोजित किया जाता है तो अर्धचालक का जो सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर हॉल या कोटरी का सांद्रता अधिक होता है जबकि जो सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर मुक्त e^- नों का सांद्रता अधिक होता है तथा आवेश का प्रवाह सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है अर्थात् अर्धचालक में धारा का प्रवाह हॉल या कोटरी के प्रवाह की दिशा में जबकि मुक्त e^- नों के प्रवाह के विपरित दिशा में होता है।

* ऊर्जा बैंड के आधार पर N-प्रकार तथा P-प्रकार की अर्धचालकों की व्याख्या -

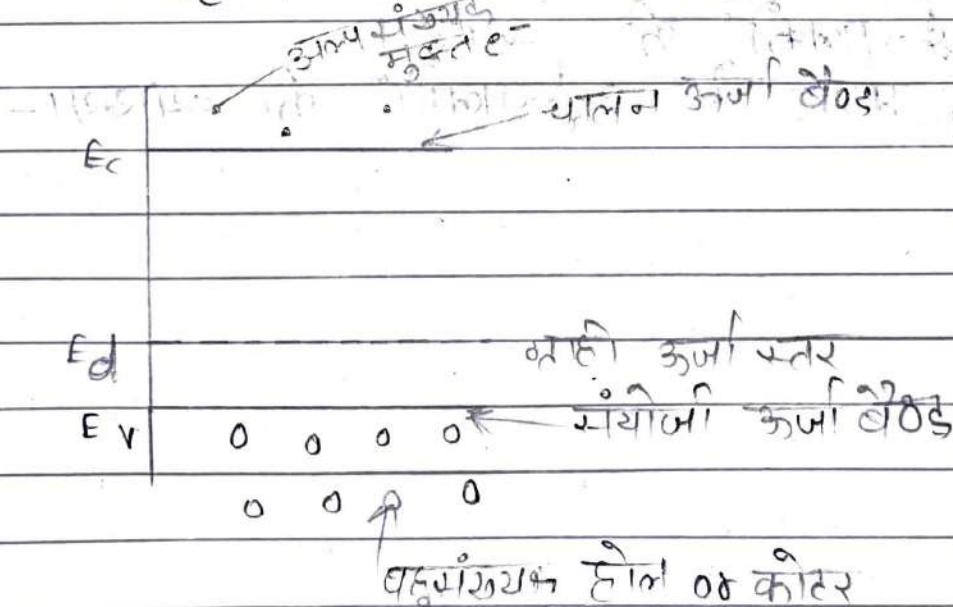
1. N-प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या -



जब किसी नैसर्ग अर्धचालक में दाता परमाणु कि अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन ऊर्जा बैंड के तल के बहुत अतिनिकट होता है जिसके कारण इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान $(E_c - E_d)$ बहुत कम होता है जिसके कारण दाता ऊर्जा स्तर के e^- तापीय कम्पनों के कारण ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और चालन ऊर्जा बैंड में प्रवेश कर जाते हैं जिससे धारा का चालन होने लगता है तथा इसके अलावा कुछ e^- तापीय ऊर्जा के कारण भी सक्रमण करके चालन ऊर्जा बैंड में पहुँच जाते हैं जिसके कारण इस स्थिति में मुक्त e^- बहुसंख्यक मात्रा में जबकि होल या कोर अल्पसंख्यक मात्रा में होते हैं जिसके कारण इन्हे N -प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है।

Note: - $(E_c - E_d)_{si} = 0.05 \text{ eV}$
 $(E_c - E_d)_{Ge} = 0.01 \text{ eV}$

* P प्रकार के अर्धचालको कि व्याख्या -



जब शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों में ग्राही परमाणु कि अशुद्धि मिलाई जाती है। इस स्थिति में ग्राही ऊर्जा स्तरों की संयोजी ऊर्जा बैंड के कुछ ऊपर स्थित हो जाती है जिससे ग्राही ऊर्जा स्तर तथा संयोजी ऊर्जा बैंड के मध्य वर्णित ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो जाता है। जिसके कारण ग्राही ऊर्जा स्तर में संयोजी ऊर्जा बैंड के ह-आसानी से प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण संयोजी ऊर्जा बैंड में रिक्त स्थान उपस्थित हो जाते हैं जिन्हे हॉल या कीटर कहा जाता है तथा इस स्थिति में हॉल या कीटर बहुसंख्यक जबकि मुक्त e- अल्पसंख्यक मात्रा में होते हैं। जिसके कारण ये p-प्रकार के अर्द्धचालक कहलाते हैं।

- Q1. अपमिश्रण कैसा लाभ है?
2. शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों कि चालकता कम क्यों होती है?
3. e- तथा हॉल या कीटर में से किसकी गतिशीलता अधिक होती है और क्यों?
4. N- प्रकार के अर्द्धचालकों में मुक्त आवेश वाहकों का नाम लिखो।
5. p- प्रकार के " " " " " "

1. शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों कि चालकता को बढ़ाने के लिए ही अपमिश्रण किया जाता है।
2. शुद्ध या नैज अर्द्धचालकों में परमशून्य ताप पर कोई आवेश वाहक \emptyset नहीं होता। जिसके कारण इस स्थिति में धारा का चलन नहीं कर पाते इस कारण इनकी चालकता कम होती है।

3. यदि इस स्थिति में e^- की गतिशीलता का मान अधिक होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होने के कारण इसका अपवाह वेग अधिक होगा जिसके कारण इसकी गतिशीलता का मान भी अधिक होगा।

4. मुक्त e^- का द्रव्यमान m_e और m_i का अनुपात $\frac{m_e}{m_i} = \frac{1}{1836}$ है।

5. यदि $n_e = n_i$ है तो $\rho = \frac{1}{n_e q_e \mu_e + n_i q_i \mu_i}$

Eg. 11.1 $T = 300K$

$\rho = ?$

$\mu_e = 0.39 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\mu_i = 0.19 \text{ m}^2/\text{Vs}$

$n_e = n_i = 9.5 \times 10^{19} / \text{m}^3$

Solu

$$\rho = \frac{1}{n_e q_e (\mu_e + \mu_i)}$$

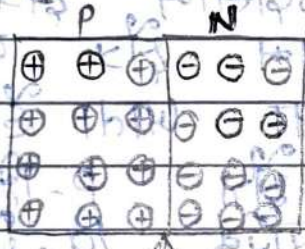
$\rho =$

Eg. 11.2 $E = \frac{hc}{\lambda}$ से

$d_{\text{max}} = \frac{hc}{E_g}$

* P-N संधि डायोड -

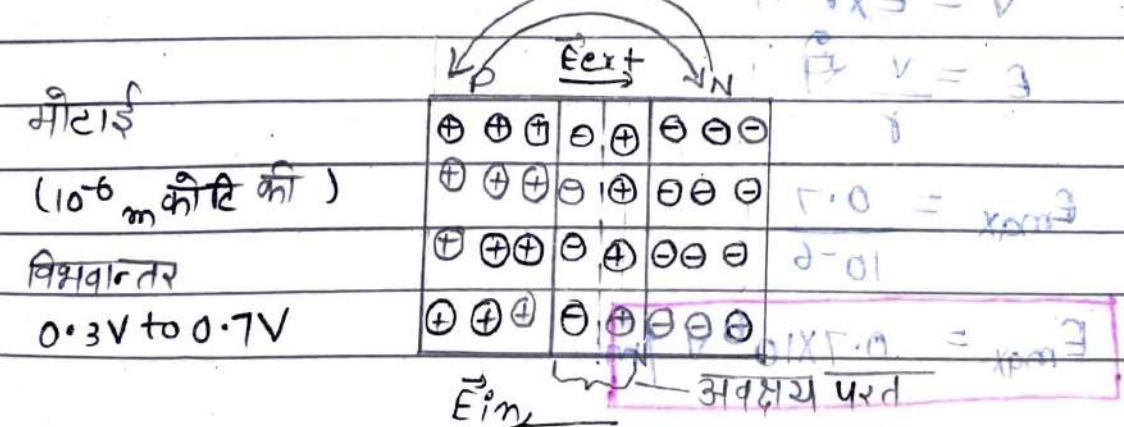
जब P-क्रिस्टल तथा N-क्रिस्टल की परमाण्वियु रूप से एक-दूसरे के सम्पर्क में लाया जाता है तो इनके मध्य एक सम्पर्क तल का निर्माण होता है इस सम्पर्क तल को P-N संधि के नाम से जाना जाता है तथा इस संधि में P-क्रिस्टल एनोड की भूमिका तथा N-क्रिस्टल कैथोड की भूमिका कार्य करता है अर्थात् इस युक्ति में दो इलेक्ट्रोड होने के कारण इसे डायोड के नाम से जाना जाता है इस कारण इसे P-N संधि डायोड के नाम से जाना जाता है



Note:- P-N संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह -



* P-N संधि पर क्रिया या अवक्षय तक परत का निर्माण -



व्याख्या -

p - N सीधे डायोड में p क्रिस्टल में हॉल या कौटरो का सांद्रण अधिक होता है जबकि N -क्रिस्टल में मुक्त e^- नों का सांद्रण अधिक होता है तथा आवेश का प्रवाह सदैव उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है अतः इससे स्पष्ट होता है कि हॉल या कौटरो p -क्रिस्टल से N -क्रिस्टल की ओर जबकि मुक्त e^- N क्रिस्टल से p -क्रिस्टल की ओर गमन करते हैं अर्थात् दोनों प्रकार के आवेश वाहक एक-दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं जिसके कारण ये इनके मध्य स्थान में क्रिया करके एक उदासीन क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं इस उदासीन क्षेत्र को ही अवक्षय परत के नाम से जाना जाता है।

इस स्थिति में बाह्य वि. क्षेत्र p -क्रिस्टल से N -क्रिस्टल की ओर जबकि आंतरिक वि. क्षेत्र N -क्रिस्टल से p -क्रिस्टल की ओर अर्थात् बाह्य वि. क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है जिसके कारण ये हॉल या कौटरो के प्रवाह में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है। तथा इस अवक्षय परत के कारण उत्पन्न विभवान्तर को रुकावट विभव विभव शीथिका या प्रॉप्पर विभव के नाम से जाना जाता है।

$$V = E \times r \text{ से}$$

$$E = \frac{V}{r} \text{ से}$$

$$E_{\max} = \frac{0.7}{10^{-6}}$$

$$E_{\max} = 0.7 \times 10^6 \text{ V/m}$$

$$E_{min} = \frac{0.3}{10^{-6}}$$

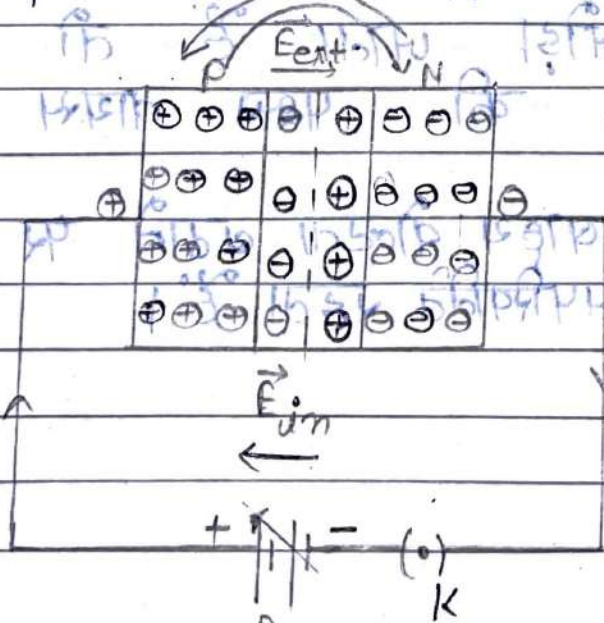
$$E_{min} = 0.3 \times 10^6 \text{ V/m}$$

* P-N संधि डायोड में धारा का प्रवाह बाह्य वोल्टता की अनुपस्थिति में P-N संधि डायोड में कोई धारा का चालन नहीं होता लेकिन बाह्य वोल्टता की उपस्थिति में P-N संधि डायोड में धारा का चालन प्रदीप्त प्रकार से होता है।

1. अग्रवायस के लिए धारा का प्रवाह
 2. पश्चिम वायस / उत्क्रमवायस के लिए धारा का प्रवाह

1. अग्रवायस के लिए धारा का प्रवाह - जब P-N संधि डायोड के P क्रिस्टल को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा N क्रिस्टल को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था डायोड का अग्र वायस कहलाती है।

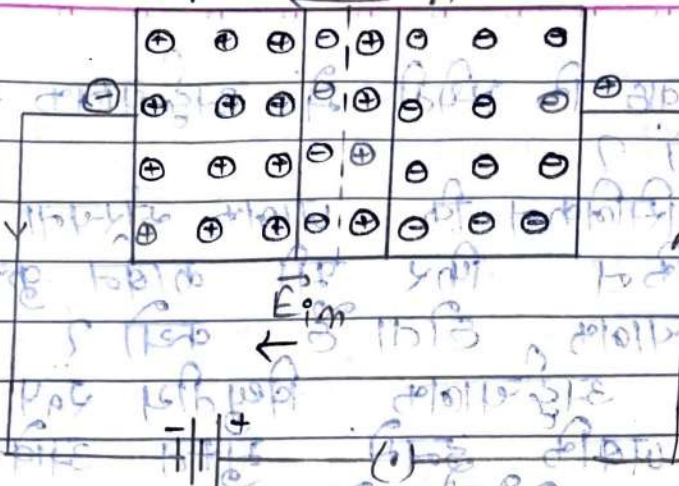
अग्रवायस पर वोल्टता बढ़ाने पर धारा के मान में वृद्धि होती है - जिसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता है कि



i) जब अग्रवायस पर बाह्य वोल्टता के मान में वृद्धि कि जाती है तो p-क्रिस्टल में उपस्थित होल या कोररि थन N क्रिस्टल में उपस्थित मुक्त e-नों पर बैटरी के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है जिसके कारण अवक्षय परत का क्षेत्रफलफल घटने लगता है अर्थात् बंधा या रोकवट के मान में कमी होने लगती है। जिससे $I = \frac{V}{R}$ होने से धारा का मान बढ़ने लगता है।

ii) p-N संधि डायोड को अग्रवायस पर रखने पर बाह्य वि. क्षेत्र तथा आंतरिक वि. क्षेत्र एक-दूसरे के विपरित दिशा में कार्यरत होते हैं। लेकिन इस स्थिति में बाह्य वि. क्षेत्र के अत्यधिक प्रभावी होने के कारण होल-थ्याप कोररि आसानी से p-क्रिस्टल से N-क्रिस्टल में प्रवेक कर जाते हैं जिसके कारण धारा के मान में वृद्धि होने लगती है।

३. पश्च वायस / उत्क्रम वायस के लिए धारा का प्रवाह -
 जब p-N संधि डायोड को p-क्रिस्टल की बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा N-क्रिस्टल की बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था p-N संधि डायोड की पश्च वायस या उत्क्रम वायस कहलाती है।
 इस स्थिति में बाह्य वोल्टता बढ़ाने पर धारा का मान अपि लगभग अपरिवर्तित रहता है।



B.

i) जब पक्ष वायस पर बाह्य वोल्टता आरोपित की जाती है। तो P हिस्टल में उपस्थित होल या कोटर तथा N हिस्टल में उपस्थित मुक्त e- पर बैटरी के आकर्षण के कारण अवस्य परत का क्षेत्रफल बढ़ने लगता है। अर्थात् बाधा या रकार के मान में वृद्धि होती है। जिससे धारा का मान लगभग अपरिवर्तित रहता है।

ii) जब P-N संधि डायोड को पक्ष वायस पर करवा जाता है तो इस स्थिति में बाह्य वि. क्षेत्र तथा आंतरिक वि. क्षेत्र एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं। जो कि होल या कोटर के प्रवाह के विपरीत दिशा में होते हैं। जिसके कारण वि. क्षेत्र अधिक होने से P हिस्टल में होल तथा कोटर N- हिस्टल में प्रवेश नहीं कर पाते। जो इसके कारण धारा के मान में उकमी (लगभग अपरिवर्तित) होती है।

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a continuation or a note.

- Q. इ अधिक धारा प्रवाह कि स्थिति में अर्द्धचालक खराब ही जाता है क्यों ?
- Q. कार्बन तथा सिलिकन कि जालक संरचना एक समान होती है लेकिन फिर भी कार्बन कुचालक जबकि सिलिकन अर्द्धचालक होता है क्यों ?
- Q. N-प्रकार के अर्द्धचालक विद्युतीय रूप से उदासीन होते है जबकि इनमें मुक्त आवेश आवेग वाहक उपस्थित होते है क्यों ?
- Q. क्या P-N संघि डायोड के सिरी पर उपस्थित विभवान्तर को वोल्टमीटर द्वारा सहायता से मापा जा सकता है ?
1. अर्द्धचालकी में प्रवाहित धारा लगभग 10 mAmp कोटि की होती है इससे अधिक धारा प्रवाहित करने पर इनके आवेश वाहको के मध्य बने बंध टुट जाते है जिसके कारण इनमें मुक्त आवेश वाहक उपस्थित हो जाते है और जिसके कारण यह चालकी के भौति व्यवहार करने लगता जाते है।
2. सिलिकन में वर्णित ऊर्जा अन्तराल का मान 1.1 eV जबकि कार्बन में 5.5 eV होता है कार्बन के वर्णित ऊर्जा अन्तराल का मान अधिक होने के कारण इसमें मुक्त आवेश वाहक प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। इस कारण कार्बन धारा का चालन नहीं कर पाता और कुचालक की भौति व्यवहार करता है।
3. ऊर्जा बैंडों के आधार पर N-प्रकार के अर्द्धचालकी

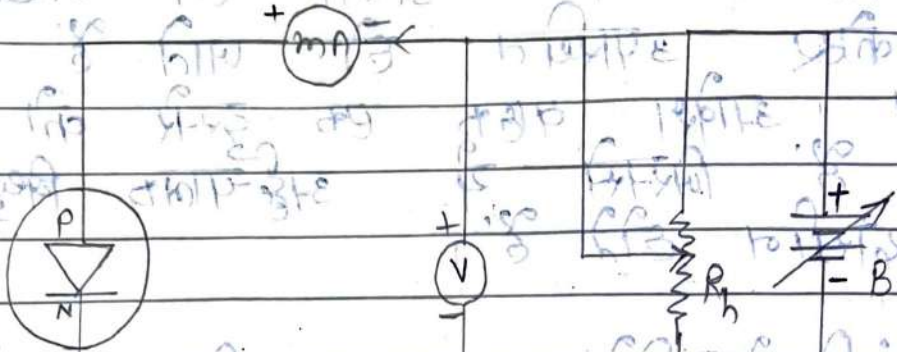
में जब दोना क्रिस्टल से e^- चलन करी बँड में प्रवेश करते हैं तो उतनी ही संख्या में होल या कीर उपस्थित हो जाते हैं जिसके कारण ये दोनो आवेश वाहक एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं जिससे ये अर्धचालक विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं।

4. P-N संधि के सिरे पर उत्पन्न विभवान्तर की वोल्टमीटर की सहायता से नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसमें उत्पन्न विभवान्तर अवक्षय फल के कारण उत्पन्न होता है।

* P-N संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र - अव P-N संधि डायोड के लिए वोल्टता (V) तथा धारा (I) के मध्य ग्राफ खींचे जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त वक्रों को ही P-N संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। P-N संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार के होते हैं -

1. अग्रवायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र
 2. उत्क्रमवायस/पश्चवायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र
1. अग्रवायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र - जब P-N संधि डायोड को अग्र वायस पर रखकर वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचे जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त ग्राफों को ही अग्रवायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है।

परिपथ चित्र -



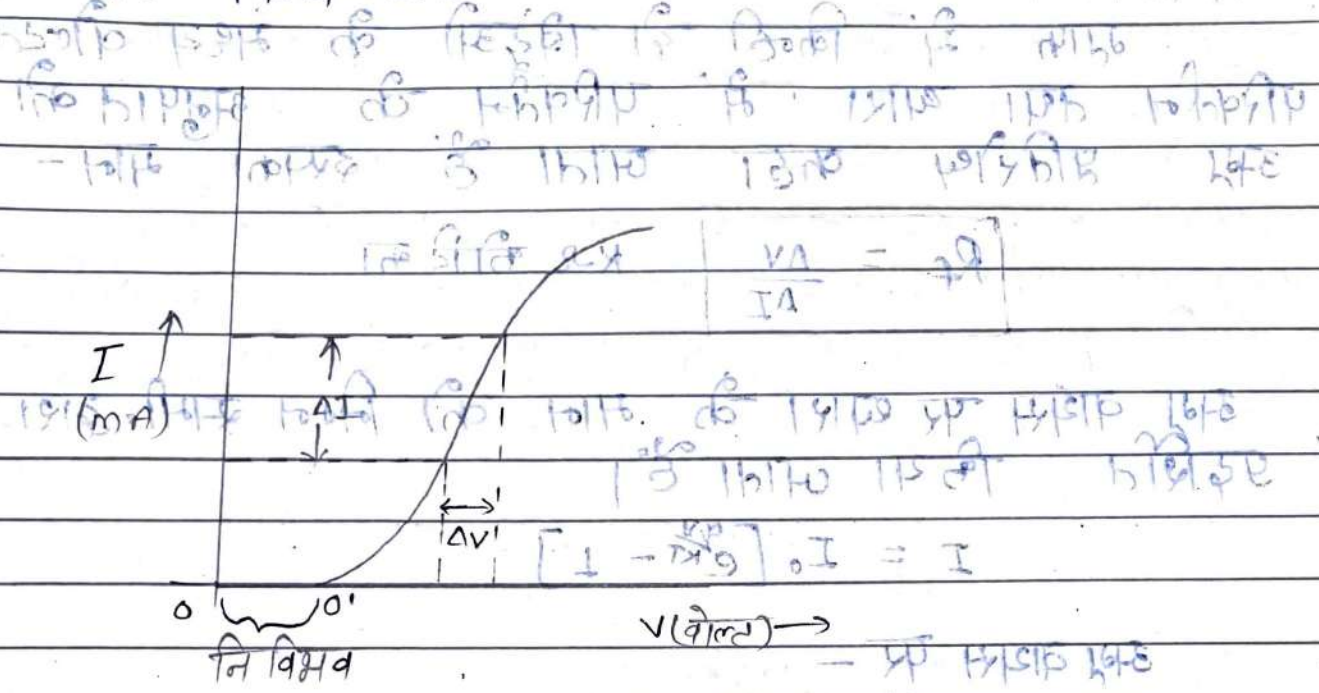
वर्णन -

p-N डायोड के p क्रिस्टल के श्रेणी क्रम में मिलिअमीटर व धारा नियंत्रक जोड़ते हुए इसे बैटरी B के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा इसके N क्रिस्टल को बैटरी B के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तथा इसके समान्तर क्रम में वोल्टता मापन के लिए एक वोल्टमीटर जुड़ा होता है।

कार्यविधि -

सर्वप्रथम बैटरी B की सहायता से वोल्टता आरोपित की जाती है जिसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है जिससे वोल्टमीटर तथा mA में तथैव पाठ्यक्रम को नोट कर लिया जाता है इसके पश्चात् धारा नियंत्रक R_h की सहायता से वोल्टता के अलग-अलग मानों के संगत धारा के अलग-अलग मान ज्ञात कर लिए जाते हैं इसके पश्चात् उक्त वोल्टता को x-अक्ष और धारा को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींच दिया जाता है यह ग्राफ ही अग्रवाक्य के लिए अभिलाषणिक वक्र कहलाता है।

जो कि निम्न है -



* अग्र वायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र की विशेषताएँ -

1. ग्राफ से स्पष्ट होता है कि V तथा I के मध्य सीधा रैखिक सम्बन्ध प्राप्त नहीं होता अर्थात् यह ओम के नियम का विधान नहीं करता।
2. ग्राफ से स्पष्ट होता है कि विद्युत 0 से 0 तक वोल्टता का मान बढ़ने पर धारा का मान शून्य ही प्राप्त होता है लेकिन इससे अधिक वोल्टता करने पर धारा का मान चर व्यातांकी रूप से बढ़ने लगता है।

नि - विभव -

Note:-

$P-N$ संयुक्त डायोड के अग्र वायस पर वह न्यूनतम विभव जिस तक धारा का मान शून्य ही बना रहता है उस विभव को नि-विभव कहा जाता है।

3. अग्र प्रतिरोध -
 ग्राफ में किन्ही दो बिंदुओं के मध्य वोल्टता में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही अग्र प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मान -

$$R_f = \frac{\Delta V}{\Delta I} \quad \text{K}\Omega \text{ कीटिका}$$

4. अग्र वायस पर धारा के मान को निम्न समी. द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

$$I = I_0 [e^{\frac{qV}{kT}} - 1]$$

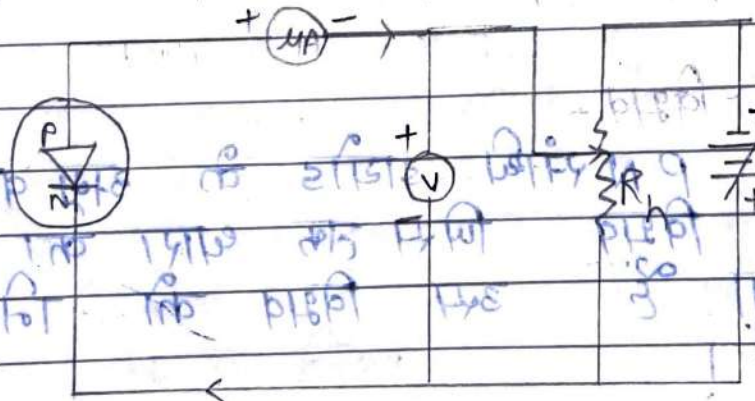
अग्र वायस पर -

$$e^{\frac{qV}{kT}} \gg 1$$

$$I = I_0 e^{\frac{qV}{kT}} \quad \text{--- (1)}$$

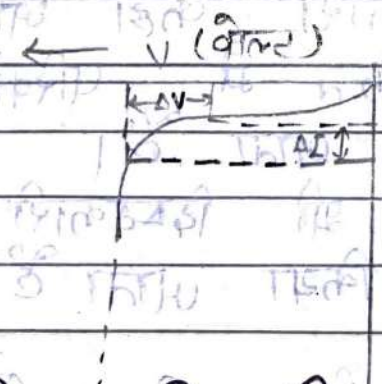
* प्र. पक्ष वायस के लिए अभिलाषिकत्व -
 उत्क्रमवायस जब PN संधि डायोड को पक्ष वायस पर तैर कर रखकर V व I के मध्य ग्राफ खींचे जाते है तो इस प्रकार प्राप्त ग्राफो को पक्ष वायस के लिए अभिलाषिक त्व कहते है।

परिपथ चित्र -



सर्वप्रथम बैटरी B की सहायता से वोल्टता आरोपित की जाती है जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाह होने लगता है। जिससे वोल्टमीटर तथा माइक्रो अमीटर में आए पाठ्यांक को नोट किया जाता है। इसके पश्चात् धारा नियंत्रक की सहायता से वोल्टता के अलग-अलग मानों के संगत धारा के अलग-अलग मान ज्ञात कर लिये जाते हैं।

इसके पश्चात् वोल्टता को $-x$ -अक्ष पर धारा को $-y$ -अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाते हैं। ये ग्राफ ही पक्ष वायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं।



* पक्ष वायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र की विशेषताएँ :-
 1. ग्राफ समझावटी होता है तथा I के मान बढ़ाये गये।
 गया ग्राफ सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं
 होता है अर्थात् यह ओम के नियम का उल्लंघन नहीं करता।

ii) अग्र प्रतिरोध \rightarrow
 ग्राम में किसी दो बिंदुओं के मध्य
 वोल्टता में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के
 अनुपात को ही अग्र प्रतिरोध कहा जाता है।
 इसका मान -

$$[R = \frac{\Delta V}{\Delta I}]$$

iii) पर्य वायस पर धारा के मान को निम्न समी.
 की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है।

$$I = I_0 [e^{v/kT} - 1] \quad \text{--- (1)}$$

पर्य वायस के लिए

$$[e^{v/kT} \ll 1]$$

समी. (1) से

$$[I = -I_0]$$

* दिष्टकारी - यह एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्याकी संकेत को दिष्ट प्रसंकेत में परिवर्तित किया जाता है। इसे दिष्टकारी कहा जाता है तथा AC संकेत को DC संकेत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दिष्टीकरण कहा जाता है।

P-N संधि डायोड का भी दिष्टकारी के रूप में निम्न प्रकार उपयोग किया जाता है।

1. P-N संधि डायोड का अर्द्धतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग
2. P-N संधि डायोड का फुलरि तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग।
3. P-N संधि डायोड का सेतु दिष्टकारी के रूप में उपयोग

1. P-N संधि डायोड का अर्द्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग -

अर्द्ध तरंग दिष्टकारी -

वह विद्युत दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के केवल धनात्मक अर्द्धचक्र अथवा आधे चक्र के लिए ही निगति संकेत प्रदान करता है उस अर्द्ध तरंग दिष्टकारी को कहा जाता है।

अर्द्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एक P-N संधि डायोड का उपयोग किया जाता है।

परिपथ चित्र -



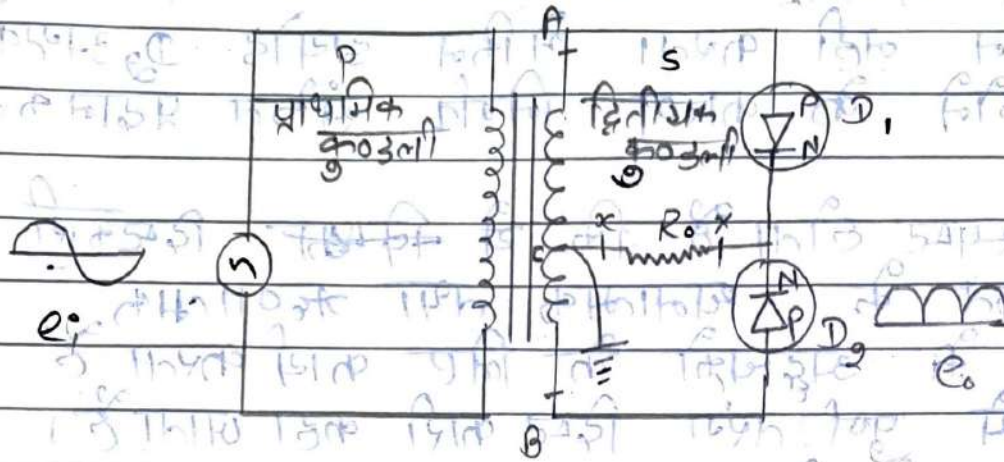
व्याख्या -

अर्द्ध तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की कुण्डलीयों का उपयोग किया जाता है तथा इसमें ट्रांसफार्मर की कुण्डलीयों इसलिए काम में ली जाती हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती संकेत की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता। इस जिस प्रत्यावर्ती संकेत की दिष्ट संकेत में बदलना होता है उसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुण्डली पर आरोपित किया जाता है जिससे द्वितीयक कुण्डली पर उसी आवृत्ति का संकेत प्राप्त होता है। इसके पश्चात् द्वितीयक कुण्डली पर धनात्मक अर्द्धचक्र अथवा A पर धन विभव व B पर ऋण विभव

आरोपित किया जाता है जिसके कारण डायोड अग्रवायस पर कार्यरत होता है जिससे निर्गत लोड प्रतिरोध R_L के सिरी के मध्य निर्गत संकेत प्राप्त होता है लेकिन अब द्वितीयक कुण्डली पर ऋणात्मक अर्द्धचक्र आरोपित A पर ऋणा विभव व B पर धन विभव आरोपित किया जाता है तो डायोड पश्च वायस पर कार्यरत होने के कारण निर्गत लोड प्रतिरोध R_L के मध्य कोई निर्गत संकेत प्रदान नहीं करता जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह यह दिष्टकारी प्रत्यावर्ती संकेत के केवल धनात्मक अर्द्धचक्र के लिए ही निर्गत संकेत प्रदान करता है ऋणात्मक अर्द्धचक्र के लिए नहीं इस कारण इसे अर्द्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। यह दिष्टकारी केवल 50% तक ही AC संकेत को DC संकेत में परिवर्तित करता है।

2. P-N संधि डायोड का पूर्णतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग -
पूर्ण तरंग दिष्टकारी -
यह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के धनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार के अर्द्धचक्रों के लिए निर्गत संकेत प्रदान करता है उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है तथा इस दिष्टकारी में समसंख्या में P-N संधि डायोड का उपयोग किया जाता है।

परिपथ चित्र -



व्याख्या -

पुर्ण तरंग दिशकारी में मध्य बिंदु ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है तथा मध्य बिंदु ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसकी द्वितीयक कुण्डली के मध्य बिंदु को भूसम्पर्कित कर दिया जाए उसे मध्य बिंदु ट्रांसफॉर्मर (मध्य निकासी ट्रांसफॉर्मर) कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती संकेत को अर्धसंकेत दिष्ट संकेत में बदलना होता है। इसे ट्रांसफॉर्मर कि सिर्फ प्राथमिक कुण्डली पर आरोपित किया जाता है जिससे द्वितीयक कुण्डली पर उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती संकेत प्राप्त होता है इसके पश्चात् द्वितीयक कुण्डली पर धनात्मक अर्धचक्र अर्थात् A सिरे पर धन विभव व B सिरे पर ऋण विभव आरोपित किया जाता है जिससे डायोड D_1 अव्यवायस पर कार्यरत होने कारण निर्गत संकेत प्रदान करना है लेकिन D_2 पक्ष्य वायस पर कार्यरत होने के कारण कोई निर्गत संकेत प्रदान नहीं करता लेकिन अब द्वितीयक कुण्डली पर ऋणात्मक अर्धचक्र

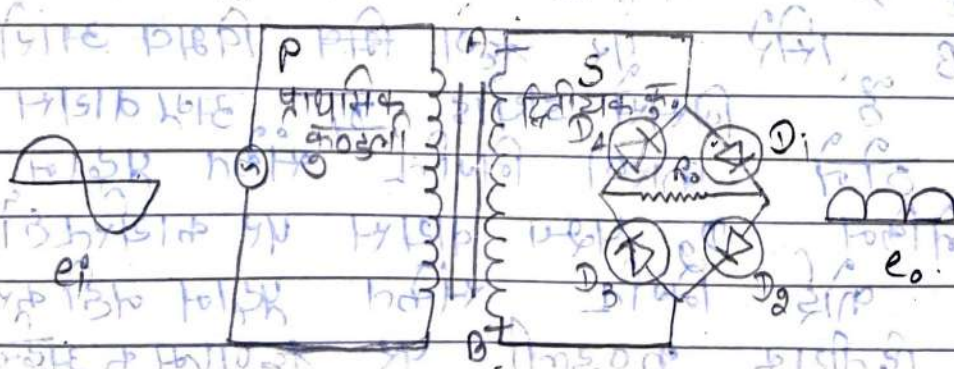
असंकेतित किया जाता है तो इस स्थिति में डायोड D_1 पक्ष वायस पर कार्यरत होने के कारण कोई निर्गत संकेत प्रदान नहीं करता लेकिन डायोड D_2 अग्रवायस पर कार्यरत होने के कारण निर्गत संकेत प्रदान करता है।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये ~~द्वि~~ दिष्टकारी प्रत्यावर्ती संकेत के धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के अर्धचक्रों के लिए कार्य करता है इस कारण इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। तथा इस दिष्टकारी के द्वारा लगभग 81.2% तक AC संकेत को DC संकेत रूप में परिवर्तित किया जाता है।

3. P-N संधि डायोड का सेतु दिष्टकारी के रूप में उपयोग -
 सेतु दिष्टकारी -

इस दिष्टकारी में मध्य बिंदु ट्रांसफॉर्मर की हटाने के लिए चार P-N संधि डायोडों का उपयोग किया जाता है तथा इनका संधि डायोडों को सेतु की रूप में जोड़ा जाता है इस कारण इसे सेतु दिष्टकारी कहते हैं।

परिपथ चित्र -

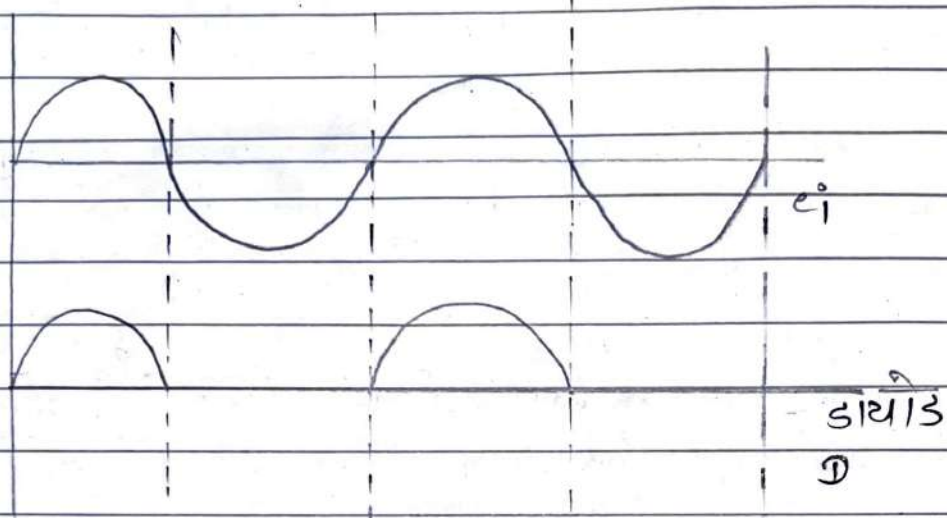


व्याख्या / कार्य विधि -

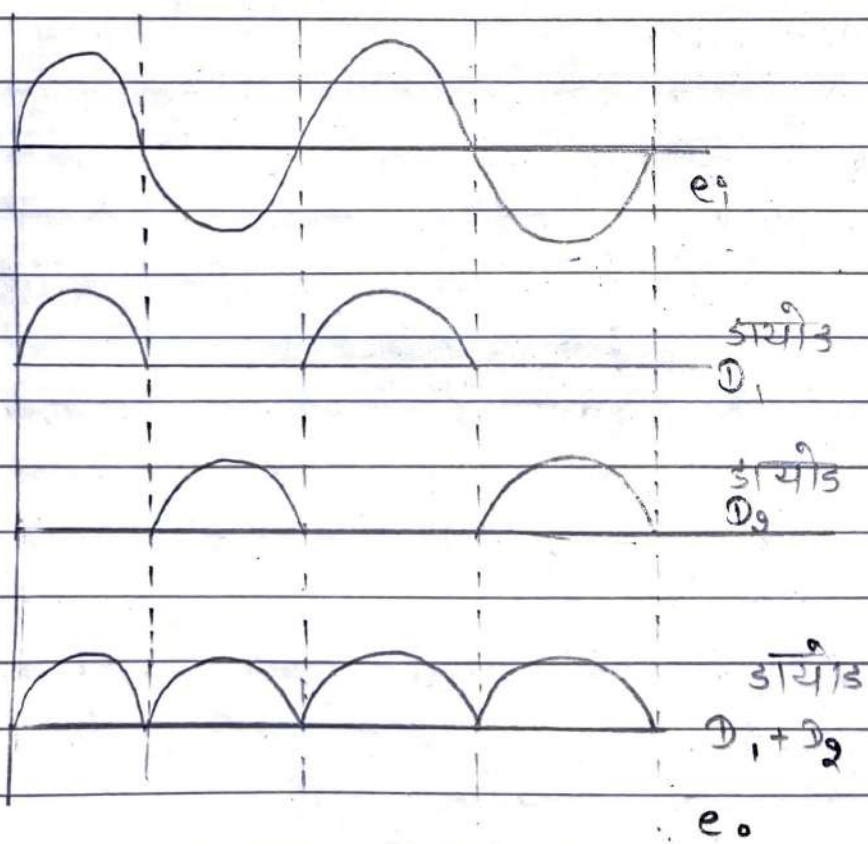
जब प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्ट संकेत में बदलना होता है तो उसे ट्रांसफॉर्मर कि प्राथमिक कुण्डली पर आरोपित किया जाता है जिससे द्वितीयक कुण्डली पर उष्ण आवृत्ति का प्रत्यावर्ती संकेत प्राप्त होता है इसके पश्चात् द्वितीयक कुण्डली पर धनात्मक अर्धचक्र अर्थात् A सिरे पर धन विभव व B सिरे पर ऋण विभव आरोपित किया जाता है जिससे डायोड D_1 व D_2 अग्र वायस पर कार्यरत होने के कारण निर्गत संकेत प्रदान करते हैं लेकिन D_3 व D_4 पश्च वायस पर कार्यरत होने के कारण कीर्ण निर्गत संकेत प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन जब द्वितीयक कुण्डली पर उष्ण आवृत्ति का अर्धचक्र आरोपित किया जाता है तो इस स्थिति में डायोड D_1 व D_2 पश्च वायस पर कार्यरत होने के कारण कोई निर्गत संकेत प्रदान नहीं करते हैं लेकिन डायोड D_3 व D_4 अग्र वायस पर कार्यरत होने के कारण निर्गत संकेत प्रदान करता है।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये द्विष्टकारी प्रत्यावर्ती संकेत को धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के अर्धचक्रों के लिए कार्य करता है इस कारण इसे सेतु द्विष्टकारी कहा जाता है तथा द्विष्टकारी के द्वारा लगभग 81.2% तक AC संकेत को DC में परिवर्तित किया जाता है।

Note:-
 1. अर्द्धतरंग दिष्टकारी के लिए संकेती का ग्राफिक निरूपण-



2. पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए संकेती का ग्राफिक निरूपण-

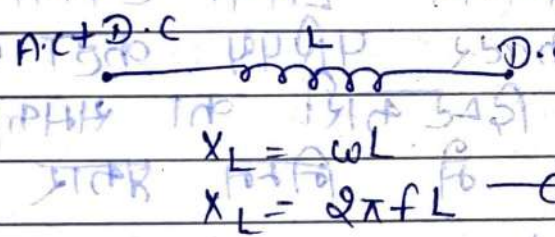


* फिल्टर परिपथ -
 वे परिपथ जो AC तथा DC के मिश्रण को पृथक् पृथक् करने के काम में लिए जाते हैं उन्हें फिल्टर परिपथ कहा जाता है।

फिल्टर परिपथ के प्रकार -
 फिल्टर परिपथ निम्न प्रकार के होते हैं -

1. शुद्ध - L फिल्टर परिपथ -

वह फिल्टर परिपथ जिसमें केवल एक प्रेरक कुण्डली जुड़ी हो तथा जो DC संकेत को पथ प्रदान करता हो उसे शुद्ध - L फिल्टर परिपथ कहा जाता है।



DC के लिए

$\therefore f = 0$
 समी. 0 से

$X_L = 0$

AC के लिए

$\therefore f > 0$
 समी. 0 से

$X_L > 0$

2. शुद्ध C फिल्टर परिपथ -

वह फिल्टर परिपथ जिसमें केवल एक संधारित्र जुड़ा हो तथा जो AC संकेत को पथ प्रदान करता है तथा DC को फिल्टर करती है उसे शुद्ध - C फिल्टर परिपथ कहा जाता है।



$$X_c = \frac{1}{\omega c}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f c}$$

D.C के लिए

$\therefore f = 0$
 समी. ① से

$$X_c = \infty (\text{अनन्त})$$

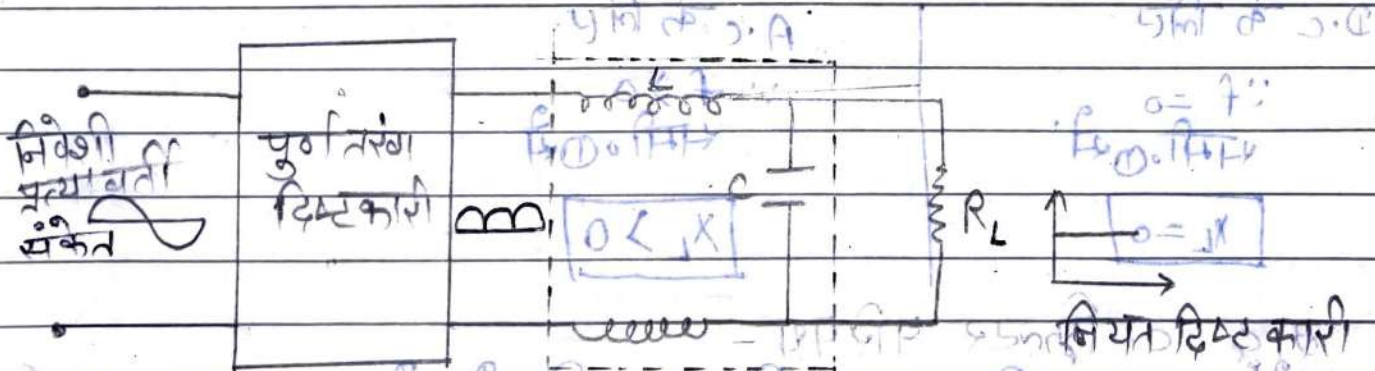
A.C के लिए

$\therefore f > 0$
 समी. ① से

$$X_c > 0$$

3. समकारी फिल्टर परिपथ -

वह फिल्टर परिपथ जिसमें L तथा C दोनों जुड़े हों उसे समकारी फिल्टर परिपथ कहा जाता है। तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी का समकारी फिल्टर परिपथ के रूप में निम्न प्रकार उपयोग किया जाता है।



कार्यविधि -

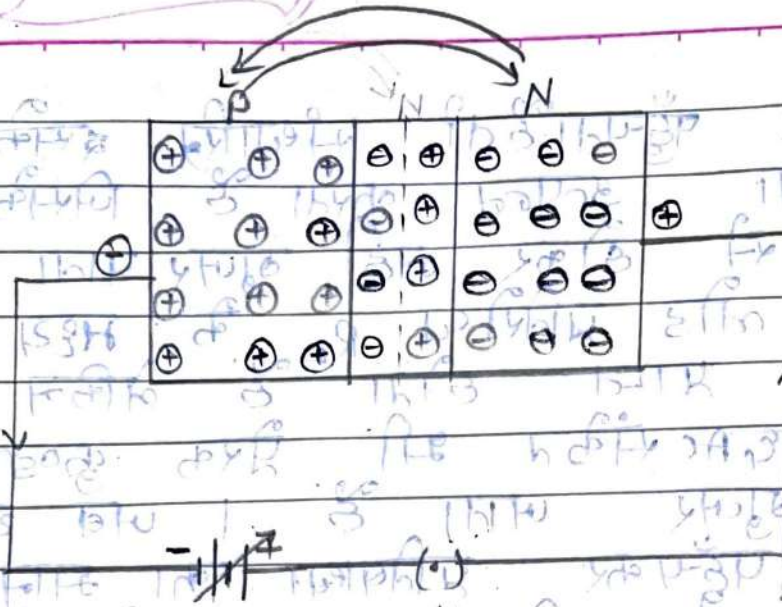
पूर्ण तरंग दिष्टकारी को प्रालत संकेतको अव समकारी फिल्टर परिपथ पर आरोपित किया जाता है ती प्ररेक कुण्डली में से D.C संकेत गुजरकर

जब संधारित्र पर पहुँचता है तो संधारित्र इसके लिए अनन्त प्रतिबाधा उत्पन्न करता है जिसके कारण यह C में से होकर नहीं गुजर पाता और इस कारण लोड प्रतिरोध R_L के मध्य नियत दिष्ट संकेत प्राप्त होता है लेकिन इस स्थिति में कुछ AC संकेत भी प्रेरक कुण्डली में से होकर गुजर जाता है। जब यह संकेत संधारित्र पर पहुँचकर प्रतिबाधा का मान कम होने के कारण भी यह संधारित्र में से होकर गुजर जाता है इस स्थिति में लोड प्रतिरोध R_L को सिरी पर केवल नियत दिष्ट संकेत ही प्राप्त होता है।

* विभिन्न प्रयोजन डायोड अथवा P-N संयुक्त डायोड का विभिन्न रूपों में उपयोग -
1. P-N संयुक्त डायोड का जेनर डायोड के रूप में उपयोग -

जेनर डायोड -
जब P-N संयुक्त डायोड को उच्च वोल्टेज पर प्रयोजित किया जाता है तो एक अवस्था ऐसी प्राप्त होती है जहाँ धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है इस स्थिति में आरोपित वोल्टता को जेनर वोल्टता तथा इस P-N संयुक्त डायोड को जेनर डायोड के नाम से जाना जाता है।

परिपथ चित्र -



क्रियाविधि -

जब P-N संधि डायोड को उत्क्रम वाह्य पर प्रचालित किया जाता है अर्थात् P-क्रिस्टल को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जबकि N-क्रिस्टल को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इस स्थिति में बैटरी के ऋण विभव के कारण P-क्रिस्टल के होलिया कोटरी पर आकर्षण जबकि बैटरी के धन विभव के कारण N-क्रिस्टल में उपास्थित मुक्त एनो पर ष्टी आकर्षण बल लगने लगता है जिसके कारण अवक्षेप परत का क्षेत्र फलित पठने लगता है जिससे अवक्षेप परत में उपास्थित आवेश वाहक के मध्य बने बंध में तनाव उत्पन्न होने लगता है तथा बाह्य वोल्टता बढ़ाने पर इनके मध्य तनाव बल का मान बढ़ता है तथा एक स्थित में इनके मध्य बने बंध टूटता जाता है जिससे इ. अल्प समय के लिए अवक्षेप परत में मुक्त आवेश वाहक उपस्थित हो जाते हैं जिसके कारण धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को जेनर भंगन कहा जाता है तथा इस स्थिति में आरोपित वोल्टता को जेनर वोल्टता या भंगक विभव के नाम

से जाना जाता है तथा इस स्थिति में P-N संंधि डायोड को जेनर डायोड के नाम से जाना जाता है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियामक के रूप में किया जाता है।

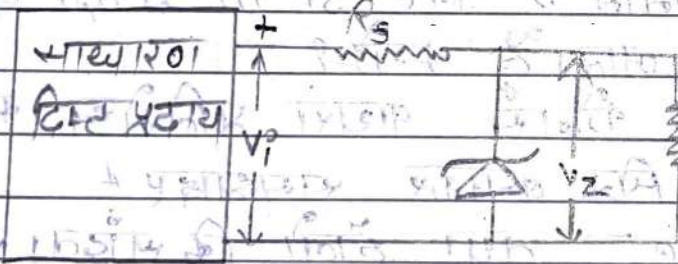
Note:- जेनर डायोड का प्रतीक चिह्न -



* जेनर डायोड का वोल्टता नियामक के रूप में उपयोग -

वोल्टता नियामक / वोल्टता स्थायीकरण -

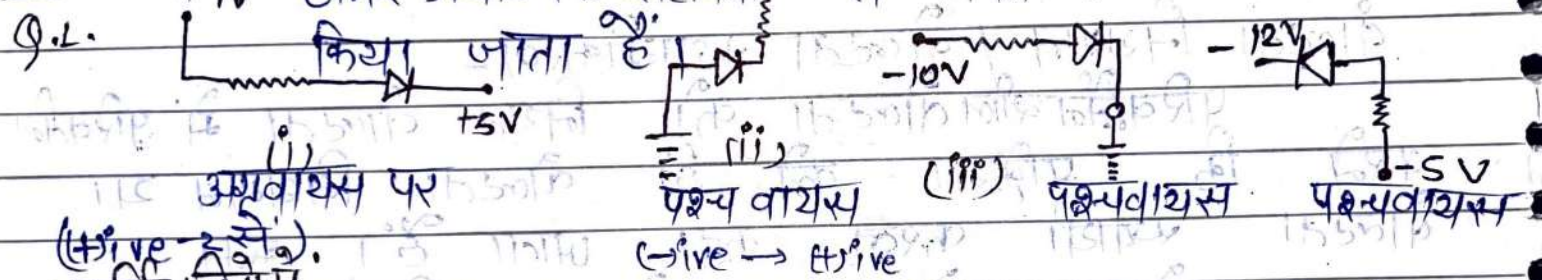
परिवर्तित वोल्टता को नियत वोल्टता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही वोल्टता नियामक या वोल्टता स्थायीकरण कहा जाता है। तथा जेनर डायोड का वोल्टता नियामक में निम्न प्रकार के उपयोग किया जाता है।



कार्यविधि -

जेनर डायोड का वोल्टता नियामक के रूप में उपयोग करने के लिए जेनर डायोड को परिपथ में इस प्रकार संयोजित किया जाता है ताकि यह उद्क्रम वायरन पर प्रचालित हो तथा जेनर डायोड उस ग्रामक विभव का लिया जाता है जिससे प्रतिरोध R_L

के सिरो पर प्राप्त करना है इसके पश्चात् जेनर डायोड पर परिकर्षणीय निवेशी वोल्टता V_1 उपरोक्त कि जाती है यदि V_1 का मान V_2 से अधिक हो तो जेनर डायोड में भंगन कि प्रक्रिया हो जाती है जिससे जेनर डायोड के सिरो पर भंगन वोल्टता V_2 ही प्राप्त होती है तथा प्रतिरोध R_L इसके समान्तर क्रम में जुड़ा होनेके कारण इसके सिरो पर भी वोल्टता V_2 ही प्राप्त होती है यदि R_L के मान को परिवर्तित कर दिया जाए तो भी इसके सिरो पर वोल्टता का मान V_2 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार परिकर्षणीय वोल्टता की जेनर डायोड कि सहायता से नियत वोल्टता में परिवर्तित



P-N संधि डायोड को कैसे वायस पर कार्यरत है कारण सहित बताए।

Q2. अर्द्धचालक युक्तियाँ बनाने के लिए Si की अपेक्षा Ge का उपयोग किया जाता है क्यों?

Q3. P-N संधि डायोड के कौनसे वायस प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है सिद्ध बनाकर समझाइए।

Q4. एक अर्द्धचालक में e^- तथा h^+ की सांद्रता का मान समान $6 \times 10^8 / m^3$ है इसमें अशुद्धी मिलाने पर e^- की सांद्रता बढ़कर $9 \times 10^{12} / m^3$ हो जाती है तो -

- i) अशुद्धी के बाद कौनसा अर्द्धचालक बनेगा।
- ii) होल या फोटरो की सांद्रता का मान ज्ञात करें।

Ans: क्योंकि Ge के लिए प्रति ऊर्जा अंतराल का मान $0.7 eV$ होता है जो कि Si के तुलना में कम है। (1.1eV)

होला है।

4. $n_e = n_H = 6 \times 10^8 / m^3$, $n_e' = 9 \times 10^{12} / m^3$

i) N - धातु का अणुघनत्व

ii) $n_i^2 = n_e n_H$

$n_H = \frac{n_i^2}{n_e}$

Q.1 $A = 2 \times 10^{-4} m^2$

$l = d = 1.2 \times 10^{-3} m$

$I = 9$, $V = 5 \text{ Volt}$

$n_i = 1.6 \times 10^6 / m^3$

$\mu_e = 0.4 \frac{m^2}{V \cdot s}$, $\mu_H = 0.2 \frac{m^2}{V \cdot s}$

Solⁿ $\rho = \frac{1}{n_i q_e (\mu_e + \mu_H)}$

$\rho = \frac{1}{1.6 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} (0.4 + 0.2)}$

$\rho = \frac{1}{1.6 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} (0.4 + 0.2)}$

$\therefore R = \frac{\rho l}{A}$

$R =$

अतः धारा से
 $I = \frac{V}{R}$

Note:- जब जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियामक के रूप में किया जाता है तो इसके श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध R_s का चयन इस प्रकार किया जाता है कि अधिकतम धारा प्रवाह की स्थिति में डायोड क्षतिग्रस्त न हो।

१. P-N संधि डायोड का फोटी डायोड के रूप में उपयोग -

फोटी डायोड -

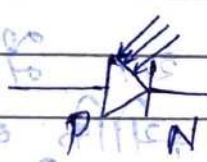
वे P-N संधि डायोड जो प्रकाशिक चालकता के प्रभाव पर आधारित होते हैं उन्हें फोटी डायोड कहा जाता है।

जब संधि के ऊपरी बैंड के e^- की ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ये e^- ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा के स्तर अथवा चालन ऊर्जा बैंड में प्रवेश कर जाते हैं तथा यह e^- मुक्त e^- चालक e^- की गति व्यवहार करने लगते हैं जिसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है इस धारा को प्रकाशिक धारा तथा इस प्रभाव को प्रकाशिक चालकता के प्रभाव के नाम से जाना जाता है तथा प्रकाशिक चालकता के प्रभाव के लिए - $e_v > E_g$ होना चाहिए।

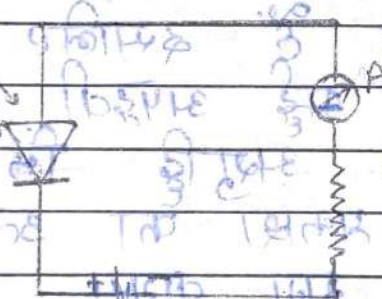
जहाँ पर e_v - आपतित प्रकाश की ऊर्जा
 E_g - वर्जित ऊर्जा अंतराल

फोटी डायोडों को सर्वेव उत्क्रम वायस पर प्रचालित किया जाता है तथा इन्हें बनाने के लिए दोनो क्रिस्टलों में से किसी एक क्रिस्टल में अपमिश्रण की मात्रा को

अधिक रखे जाते हैं तथा अवधुय परत का क्षेत्रफल कम हो तथा आसानी से संयोजी ऊर्जा बैंड के e- चालन ऊर्जा बैंड में प्रवेश कर सकें अर्थात् प्रकाशिक चालकता के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकें। इस स्थिति में यदि निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश की इन डायोडों पर आपतित कराया जाता है तो परिपथ में प्रकाशिय विद्यारा का प्रवाह होने लगता है। इस स्थिति में यदि आवृत्ति को नियत रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए अर्थात् प्रकाश विद्यारा का मान भी कम बढ़ने लगता है तथा फोटो डायोड के प्रतीक चिन्ह को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं -



Page 392
16.30

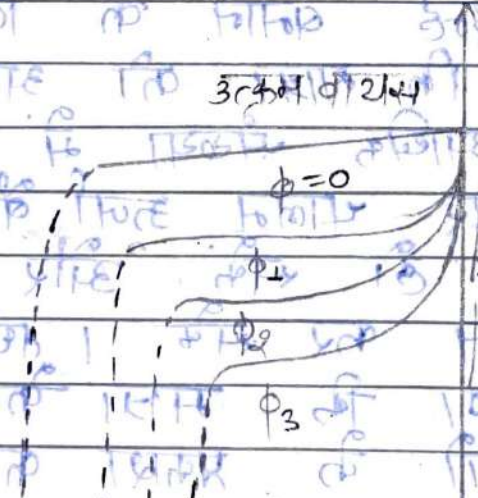


$\phi =$ प्रकाश की तीव्रता
 ϕ प्रकाश आपतित नहीं

$$\phi_3 > \phi_2 > \phi_1 > 0$$

$$\phi = 0$$

$V \rightarrow$



ϕ_3

प्रकाश की तीव्रता

फोटी डायोडों को उपयोग निम्नलिखित युक्तियों में किया जाता है -

1. प्रकाश संसूचन में
2. प्रकाश चालित स्विच
3. फिल्मों में ध्वनि पुनः उत्पादन
4. कम्प्यूटर टेप कार्ड पढ़ने में

* 3. P-N संधि डायोड का प्रकाश उत्सर्जक डायोड (L.E.D.) के रूप में उपयोग -

प्रकाश उत्सर्जक डायोड -
ये P-N संधि डायोड जिन्हें अग्र वायस पर प्रचालित करने पर ये प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं। उन्हें प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है।

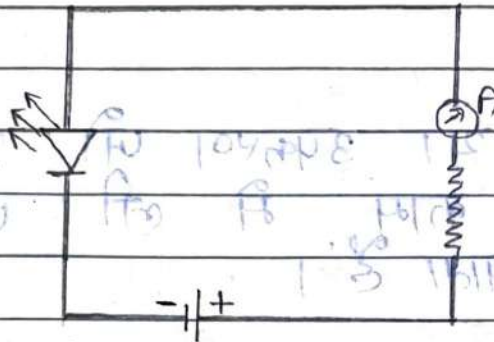
इन्हें बनाने के लिए शुद्ध या नैप अर्द्धचालकों का उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि इनमें अशुद्धि कि मात्रा कम होने के कारण ये कम प्रकाश का उत्सर्जन कर पाते हैं। इसलिए इन्हें बनाने के लिए बाइय या अर्द्ध अपेक्षी अर्द्धचालकों का उपयोग किया जाता है ताकि अशुद्धि कि मात्रा अधिक होने से यह अधिक प्रकाश का उत्सर्जन कर सकें।

तथा इन्हें सर्वेव अग्र वायस पर प्रचालित किया जाता है तथा इन्हें बनाने के लिए दोनो क्रिस्टलों में अपमिश्रण कि मात्रा को अधिक रखा जाता है। ताकि अधिक से अधिक संख्या में संयोजी ऊर्जा बैंड के होल या कोटर चालन ऊर्जा बैंड के e-नों के साथ पुनः संयोजित हो सकें और अधिक मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन कर सकें। तथा क्रिस्टल कि प्रकृति व अपमिश्रण कि मात्रा के आधार पर यह अलग - अलग रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं।

LED का प्रतीक चिन्ह -



परिपथ चित्र -



LED का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों में किया जा रहा है।

1. सूचक लाइट के रूप में
2. सल्ट खंड प्रदर्शन इकाई के रूप में।
3. उच्च तीव्रता के प्रकाश उत्पन्न करने वाले LED का प्रकाशिक तन्तु संयार में।
4. कम शक्ति व्ययिकर उच्च तीव्रता का प्रकाश देने वाले

LED बल्ब।

Q.1 P-N संधि डायोड के पक्ष वायस पर धारा माइक्रो एम्पियर कोटि कि प्राप्त होती है क्यो ?

Q.2 P-N संधि डायोड के P-क्रिस्टल को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा N-क्रिस्टल को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ने पर यह व्यवस्था अववायस कहलाती है क्यो ?

क्योकि P-N संधि डायोड के पक्ष वायस पर अपेक्षा बलक अल्पसंख्यक होते हैं जो कि होल या कॉरर हैं इन्ही के कारण पक्ष वायस पर धारा का मान माइक्रो एम्पियर कोटी का प्राप्त होता है।

om prakash saini

इस स्थिति में P-क्रिस्टल में उपस्थित हॉल या कोटर प्रतिकर्षण बल के कारण N-क्रिस्टल की ओर गमन करते हैं अर्थात् हॉल या कोटर P-क्रिस्टल से N-क्रिस्टल अर्थात् अग्र दिशा में गमन करते हैं। इस कारण इसे अग्र वायस कहा जाता है।

ट्रांजिस्टर -

वे युक्ति या उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों के प्रवर्धन में काम में ली जाती हैं उसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है।

अथवा

उस युक्ति या उपकरण जो वि. परिपथ में ट्रायोड वाक्य के स्थान पर काम में ली जाती है उसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है तथा यह तीन टर्मिनलों युक्त युक्ति होती है।

Note:- ट्रांजिस्टर का आविष्कार वैज्ञानिक वार्डीन व शोकले ने किया था।

ट्रांजिस्टर के मुख्य भाग -

ट्रांजिस्टर निम्न तीन मुख्य भागों से मिलकर बना होता है -

1. आधार (Base) B -
2. अमीटर (उत्सर्जक) E :-
3. संग्राहक (collector) C

आधार -

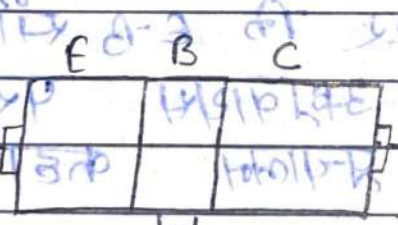
ट्रांजिस्टर के इस भाग का मुख्य कार्य उत्सर्जक से प्राप्त आवेश वाहकों को संग्राहक तक पहुँचाने

का होता है। इसी कारण इस भाग क्षेत्रफल अन्य दोनो भागों कि तुलना में कम रखा जाता है तथा इसमें मादन (अशुद्धि की मात्रा) भी अन्य दोनो भागों कि तुलना में कम होता है।

इस प्रकार इस भाग का मुख्य कार्य आवेश वाहकों को उत्सर्जित करने का होता है। इसी कारण इसी भाग में मादन कि मात्रा अन्य दोनो भागों कि तुलना में अधिक होती है। लेकिन इसका क्षेत्रफल आधार से अधिक लेकिन संग्राहक से कम होता है।

संग्राहक -

इस भाग का मुख्य कार्य उत्सर्जक से आवेश वाहकों को संग्रहित करने का होता है। इसी कारण इस भाग का क्षेत्रफल अन्य दोनो भागों कि तुलना में अधिक होता है। लेकिन मादन आधार से अधिक लेकिन उत्सर्जक से कम होता है।



इस प्रकार इस भाग का मुख्य कार्य उत्सर्जक से आवेश वाहकों को संग्रहित करने का होता है। इसी कारण इस भाग का क्षेत्रफल अन्य दोनो भागों कि तुलना में अधिक होता है। लेकिन मादन आधार से अधिक लेकिन उत्सर्जक से कम होता है।

इस प्रकार इस भाग का मुख्य कार्य उत्सर्जक से आवेश वाहकों को संग्रहित करने का होता है। इसी कारण इस भाग का क्षेत्रफल अन्य दोनो भागों कि तुलना में अधिक होता है। लेकिन मादन आधार से अधिक लेकिन उत्सर्जक से कम होता है।

इस प्रकार इस भाग का मुख्य कार्य उत्सर्जक से आवेश वाहकों को संग्रहित करने का होता है। इसी कारण इस भाग का क्षेत्रफल अन्य दोनो भागों कि तुलना में अधिक होता है। लेकिन मादन आधार से अधिक लेकिन उत्सर्जक से कम होता है।

1. E - B संधि
2. B - C संधि

इन संधियों के आधार पर ट्रांजिस्टर को निम्न चार क्षेत्रों में प्रचालित किया जाता है।

1) सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन -
जब ट्रांजिस्टर कि E-B संधि अग्र वायस पर तथा B-C संधि पश्च वायस पर कार्यरत होती तो इसे सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन कहा जाता है।

2) संतृप्त क्षेत्र में प्रचालन -
जब ट्रांजिस्टर कि E-B संधि तथा B-C संधि दोनों कार्यरत ही अग्र वायस पर कार्यरत ही तो इसे संतृप्त क्षेत्र में प्रचालन कहा जाता है।

3. अन्तक क्षेत्र में प्रचालन -
जब ट्रांजिस्टर कि E-B संधि तथा B-C संधि दोनों ही कार्यरत ही पश्च वायस पर कार्यरत ही तो इसे अन्तक क्षेत्र में प्रचालन कहा जाता है।

4. प्रतिरोम क्षेत्र में प्रचालन -
जब ट्रांजिस्टर कि E-B संधि पश्च वायस पर तथा B-C संधि अग्र वायस पर कार्यरत ही तो इसे प्रतिरोम क्षेत्र में प्रचालन कहा जाता है।

* ट्रांजिस्टर के प्रकार -

ट्रांजिस्टर निम्न दो प्रकार के होते हैं -

1. P-NP ट्रांजिस्टर

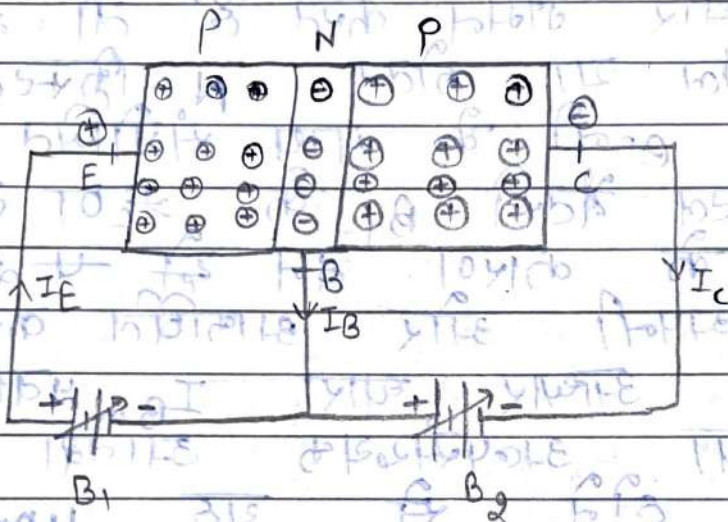
2. NPN ट्रांजिस्टर

जिस E-B

जिस B-C

1. PNP ट्रांजिस्टर -

जब दो मोटे P-क्रिस्टल के मध्य एक पतले N-क्रिस्टल को दबाकर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी व्यवस्था को PNP ट्रांजिस्टर कहा जाता है।



वर्तन -

PNP ट्रांजिस्टर में बाएँ P-क्रिस्टल को बैरी B₁ के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है जिसके कारण यह उत्सर्जक का कार्य करता है तथा N-क्रिस्टल को बैरी B₂ के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तथा यह आधार का कार्य करता है तथा दाएँ P-क्रिस्टल को बैरी B₃ के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है जिसके कारण यह अवशोषक का कार्य करता है। अर्थात् संग्राहक की भाँति व्यवहार करता है। इसमें E-B संधि अग्र वायस पर B-C संधि पश्च वायस पर कार्यरत होती है।

कार्यविधि -

जब PNP ट्रांजिस्टर के बाएँ P-क्रिस्टल पर

बैटरी B₁ के धन टर्मिनल के कारण प्रतिकर्षण बन लगता है तो पॉजिटिव इसमें अपास्थित होला या कोटर बाएँ P-क्रिस्टल से काएँ P-क्रिस्टल कि ओर गमन करते हैं इस स्थिति में 100% होला या कोटर जब B बाएँ P-क्रिस्टल से काएँ P-क्रिस्टल कि ओर गमन करते हैं तो इस स्थिति में 2% होला या कोटर N-क्रिस्टल में अपास्थित मुक्त e⁻ नों के साथ संयोजित हो जाते हैं तथा N-क्रिस्टल बैटरी B₁ के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होने के कारण इन के 2% होला या कोटरों की अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिसके कारण अक्षर धारा I_B प्रवाहित होने लगती है तथा अपसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होने से यह 2 amp. कोटि की होती है औष 98% होला या कोटर जब दाएँ P-क्रिस्टल कि ओर प्रवेश करते हैं तो वह बैटरी B₂ के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होने के कारण 98% होला या कोटरों की अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे संग्राहक धारा- I_C प्रवाहित होती है तथा यह धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह 5 मिली एम्पीयर की होती है तथा जब बैटरी B₁ के धन टर्मिनल से पुनः 100% होला या कोटरों को बाएँ P-क्रिस्टल में प्रवेश कर दिया जाता है तो इनके कारण उत्सर्जक धारा I_E प्रवाहित होती है यह भी 5 मिली एम्पीयर की होती है।

गणना की. 9 पाठ के प्रश्नों पर 100

PNP ट्रांजिस्टर कि विशेषताएँ -

1. इस ट्रांजिस्टर में I_E तथा I_C धारा मिलीम्पियर की होती है जबकि I_B धारा μA μAmp की होती है।

2. इस ट्रांजिस्टर में किरचॉफ के लूप नियम कि सहायता से -

$$I_E = I_B + I_C$$

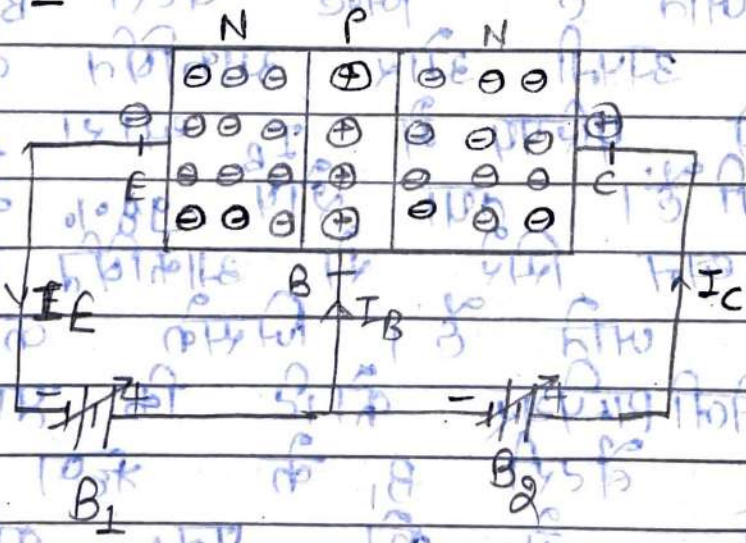
$$\therefore I_B \ll I_C$$

$$I_C \approx I_E$$

3. इस ट्रांजिस्टर में E-B संधि अग्रवायस पर जबकि B-C संधि पश्च वायस पर कार्यरत होती है। कौनो संधियाँ अग्रवायस या पश्च वायस पर कार्यरत नहीं हो सकती हैं।

4. **NPN ट्रांजिस्टर -** जब दो मोटे N-क्रिस्टलों के मध्य एक पतले p-क्रिस्टल की कटाई करवा जाता है तो इस प्रकार बनी व्यवस्था को NPN ट्रांजिस्टर कहा जाता है।

परिपथ चित्र -



वर्णन -

NPN ट्रांजिस्टर में बाएँ N-क्रिस्टल को बैटरी B₁ के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है जिसके कारण यह उत्सर्जक का कार्य करता है तथा P-क्रिस्टल को बैटरी B₁ के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है तथा यह आधार का कार्य करता है तथा दाएँ N-क्रिस्टल को बैटरी B₂ के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जिसके कारण यह आवेश वाहकों को संग्रहित करने का कार्य करता है। अर्थात् संग्राहक कि भूमि व्यवहार करता है। इसमें E-B संघि अर्थात् वायस पर व B-C संघि पर वायस पर कार्यरत होती है।

कार्यविधि -

सर्वप्रथम बैटरी B₁ की सहायता से NPN ट्रांजिस्टर पर वोल्टता आरोपित कि जाती है। जिससे बाएँ N-क्रिस्टल में उपस्थित मुक्त e-नों पर बैटरी B₁ के ऋण टर्मिनल के कारण प्रतिकर्षण विभव लगता है जिससे 100% मुक्त e- बाएँ N-क्रिस्टल से दाएँ N-क्रिस्टल की ओर गमन करते हैं। इनमें से शु. मुक्त e- P-क्रिस्टल में उपस्थित होल या कोरों के साथ संयोजित हो जाते हैं जिन्हें बैटरी B₁ के धन टर्मिनल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है जिससे परिपथ में I_B द्वारा μAmp कोटि की प्राप्त होती है। तथा शेष 98% मुक्त e- बैटरी B₂ के धन सिरे से आकर्षित होकर संग्राहक से बाहर चले जाते हैं। जिसके कारण परिपथ में I_C द्वारा मिली एम्पियर कोटि की प्राप्त होती है। इसके पश्चात् बैटरी B₁ के ऋण टर्मिनल के द्वारा 100% मुक्त e-नों को पुनः बाएँ N-क्रिस्टल

में प्रवेश करा दिया जाता है जिससे परिपथ में ई धारा मिली एम्पियर कोटि प्राप्त होती है।

NPN ट्रांजिस्टर कि विशेषताये -

1. इस ट्रांजिस्टर में I_E तथा I_C धारा मिली एम्पियर कोटि जबकि I_B धारा $\mu Amp.$ कोटि की होती है।

2. इस ट्रांजिस्टर में किर्याफ के लुप नियम कि सहायता से -

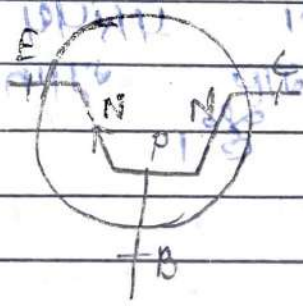
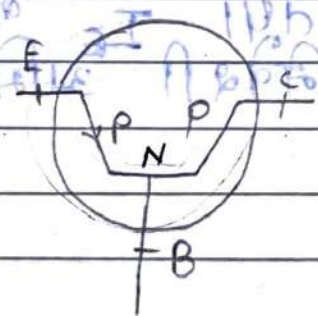
$$I_E = I_B + I_C$$

$$\therefore I_B \ll I_C$$

$$I_B \cong I_C$$

3. इस ट्रांजिस्टर में E-B संधि अग्रवायस पर जबकि B-C संधि पश्च वायस पर कार्यरत होती है। दोनों संधियाँ अग्रवायस या पश्चवायस पर कार्यरत नहीं हो सकती हैं।

Note:- PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह -



*** ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र -**

किसी ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टता (V) तथा धारा (I) के मध्य खींचे गए ग्राफ ही ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं तथा यह निम्न तीन प्रकार के होते हैं -

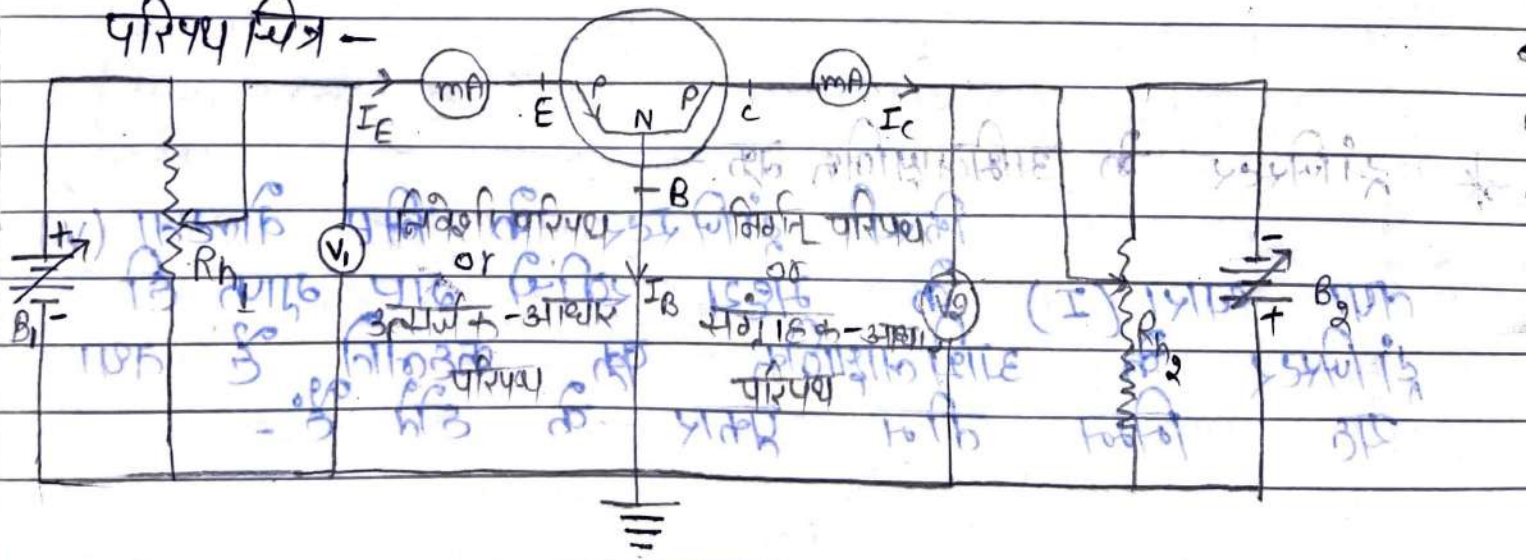
1. उभय निष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्र
2. उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्र
3. उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्र

1. उभय निष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्र -
जब किसी ट्रांजिस्टर के आधार को उभयनिष्ठ वोल्टता पर रख दिया जाता है अर्थात् ध्रुव-सम्पर्कित कर दिया जाता है उसे ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास कहा जाता है तथा इस अभिविन्यास के लिए दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं -

- i) निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र
- ii) निगति अभिलाक्षणिक वक्र

i) निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र -
जब किसी ट्रांजिस्टर के आधार को उभयनिष्ठ वोल्टता को रखकर निगति परिपथ में प्राप्त संग्राहक वोल्टता (V_C) को नियत मानु पर रखकर निवेशी परिपथ में V_E तथा I_E के मध्य खींचे गए ग्राफ ही निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं।

परिपथ चित्र -



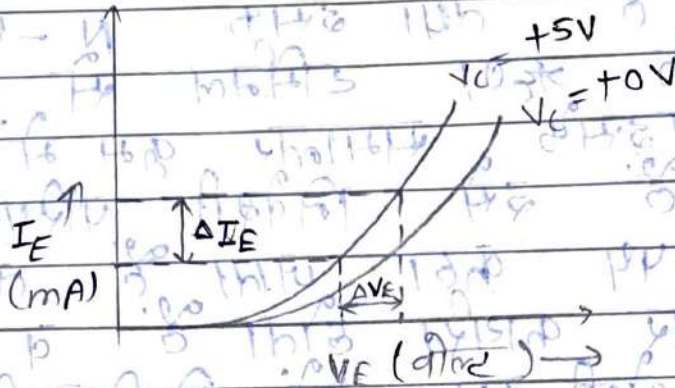
वर्तन-

P_{NP} ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक P -क्रिस्टल के श्रेणी क्रम में मिलीअमीटर व द्वारा नियंत्रक R_{h1} जोड़ते हुए इसे बैटरी B_1 के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तथा इसके N -क्रिस्टल को बैटरी B_1 के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है व इसके समान्तर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा होता है इसे निवेशी परिपथ या उत्सर्जक आधार (E_0) परिपथ कहा जाता है तथा यह अग्रवायस पर कार्यरत होता है व संग्राहक P -क्रिस्टल के श्रेणी क्रम में मिलीअमीटर व द्वारा नियंत्रक R_{h2} जोड़ते हुए इसे बैटरी B_2 के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है व इसके समान्तर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा होता है इसे निर्वृत् परिपथ या E_0 आधार संग्राहक ($B-C$) परिपथ कहा जाता है यह पश्च वायस पर कार्यरत होता है।

क्रियाविधि-

सर्वप्रथम निर्वृत् परिपथ में बैटरी B_2 की सहायता से वोल्टता आरोपित करके संग्राहक वोल्टता को एक नियत मान पर रख दिया जाता है इसके पश्चात् निवेशी परिपथ में बैटरी B_1 की सहायता से वोल्टता आरोपित करके V_E तथा I_E के पाठ्यांक नोट कर लिए जाते हैं। इसके पश्चात् द्वारा नियंत्रक R_{h1} की सहायता से वोल्टता V_E के अलग-अलग मानों के संगत I_E उत्सर्जक द्वारा के अलग-अलग मान ज्ञात कर लिए जाते हैं इसके पश्चात् V_E उत्सर्जक वोल्टता को

X-अक्ष पर I_E को Y-अक्ष पर लोकर ग्राफ खींचा दिया जाता है इस ग्राफ को ही निवेशी अभिलासिक वक्र कहा जाता है जो कि निम्न है।



निवेशी अभिलासिक वक्र कि विशेषताएँ -

1. ग्राफ से स्पष्ट होता है V_E तथा I_E के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता अर्थात् ओम के नियम का पालन नहीं करता है।
2. ग्राफ से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में V_E वोल्टता का मान बढ़ाने पर द्वारा I_E का मान शुरु ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात् V_E को बढ़ाने पर I_E का मान बढ़ने लगता है।
3. निवेशी प्रतिरोध -
 ग्राफ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही निवेशी प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मान -

$$R_i = \left(\frac{\Delta V_E}{\Delta I_E} \right)_{V_C = \text{const.}}$$

4. चालकता -

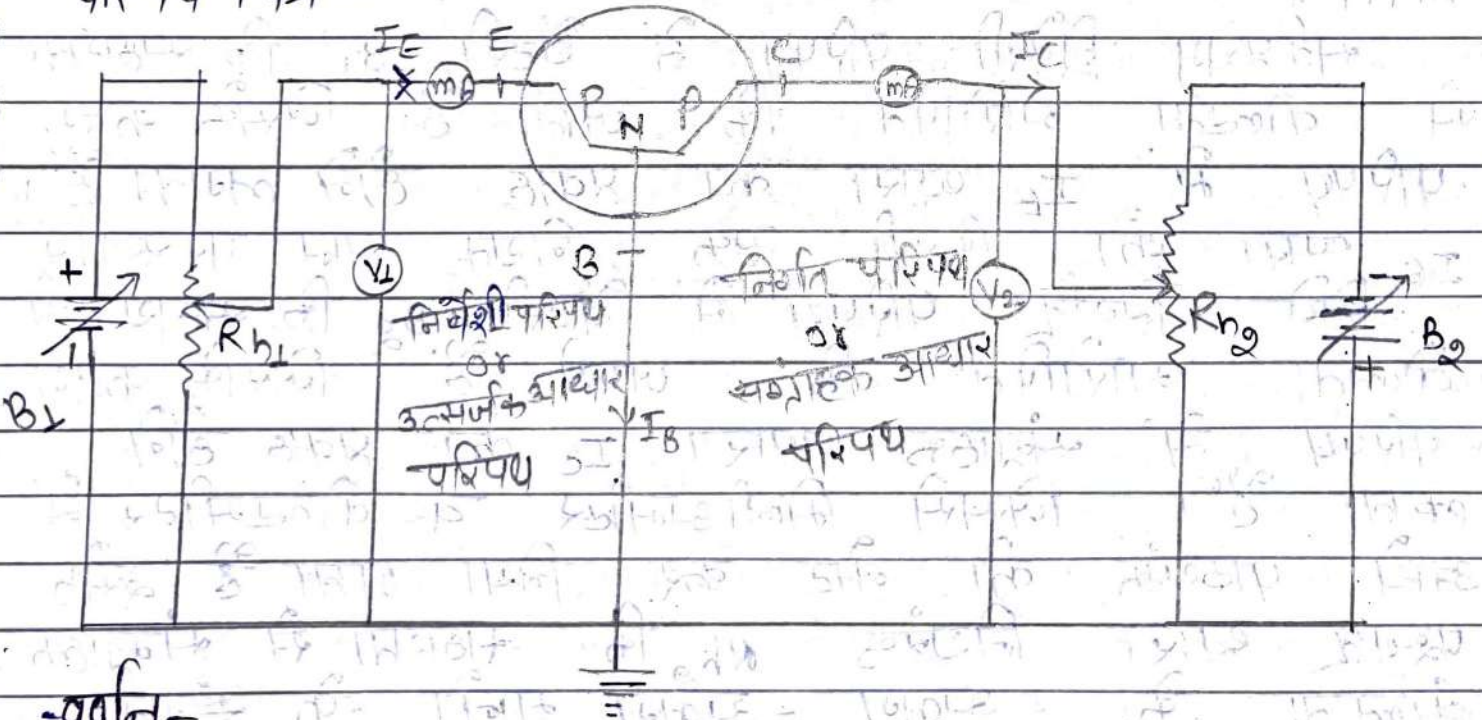
निवेशी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। इसका मान -

$$\sigma = \frac{1}{R_i} = \left(\frac{\Delta I_E}{\Delta V_E} \right)_{V_C - \text{Const.}}$$

ii. निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र -

जब किसी ट्रांजिस्टर के आधार को उभयनिष्ठ वोल्टता पर रखकर निवेशी परिपथ में प्राप्त उत्सर्जक धारा (I_E) को नियत मान पर रखकर निर्गत परिपथ में V_C तथा I_C के मह्य खींचे गए ग्राफ ही निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं।

परिपथ चित्र -



वर्णन -

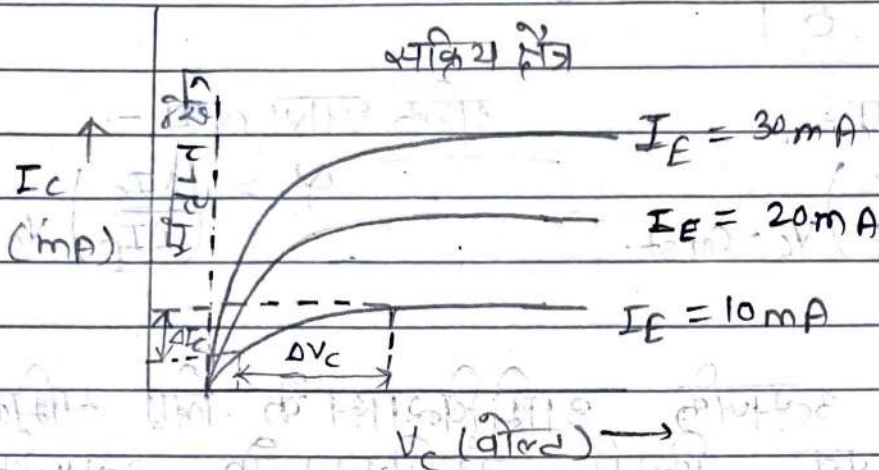
PNP ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक p क्रिस्टल के शीर्षक में मिली एम्पीयर धारा नियंत्रक R_{B1} , जोड़ते हुए इसे बैटरी B_1 के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है।

तथा इसके N-क्रिस्टल को B_1 के क्रिस्टल टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तथा इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर जुड़ा होता है। इसे निवेशी परिपथ या उत्सर्जक आधार परिपथ कहा जाता है। तथा यह अंग वायस पर कार्यरत होता है। व संग्रहक C क्रिस्टल के श्रेणीक्रम में मिली अमीटर व धारा नियंत्रक R_h जोड़ते हुए इसे बैटरी B_2 के क्रिस्टल टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। व इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा होता है। इसे निर्गत परिपथ या BC परिपथ कहा जाता है। तथा यह पक्ष्य वायस पर कार्यरत होता है।

- कार्यविधि -

सर्वप्रथम निवेशी परिपथ में बैटरी B_1 की सहायता से वोल्टता आरोपित कि जाती है जिसके कारण परिपथ में I_E धारा का प्रवाह होने लगता है। I_E धारा को किसी एक नियत मान पर रखकर निवेशी निर्गत परिपथ में बैटरी B_2 की सहायता से वोल्टता आरोपित कि जाती है जिसके कारण परिपथ में संग्रहक धारा I_C का प्रवाह होने लगता है। जिससे मिलीअमीटर व वोल्टमीटर में आये पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है इसके पश्चात् धारा नियंत्रक R_h की सहायता से संग्रहक वोल्टता के अलग-अलग मानों के संगत संग्रहक धारा के अलग-अलग मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। इसके पश्चात् V_C के x -अक्ष पर तथा I_C के y -अक्ष पर लेकर ग्राफ खींच

दिया जाता है। इन ग्राफो को ही निगति अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है जो कि निम्न हैं।



निगति अभिलाक्षणिक

1. ग्राफ से स्पष्ट होता है V_c व I_c के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता अतः यह ओम के नियम का पालन नहीं करता।
2. ग्राफ से स्पष्ट होता है प्रारम्भ में V_c का मान बढ़ाने पर I_c का मान भी बढ़ता है लेकिन कुछ ही समय में धारा I_c अपने संतृप्त मान को प्राप्त कर लेती है। इसके पश्चात् V_c को बढ़ाने पर I_c का मान अपरिवर्तित रहता है।

निगति प्रतिरोध -

3. ग्राफ में किन्ही दो बिंदुओं के मध्य संग्राहक वोल्टता में परिवर्तन तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही निगति प्रतिरोध कहा जाता है।

$$R_o = \left(\frac{\Delta V_c}{\Delta I_c} \right)_{I_b = \text{const.}}$$

4. धारा लाभ -
 निर्गत परिपथ में प्राप्त धारा तथा निवेशी परिपथ में प्राप्त धारा के अनुपात को ही धारा लाभ कहा जाता है।

स्थैतिक धारा लाभ -

$$\alpha = \left(\frac{I_c}{I_E} \right) V_c - \text{Const.}$$

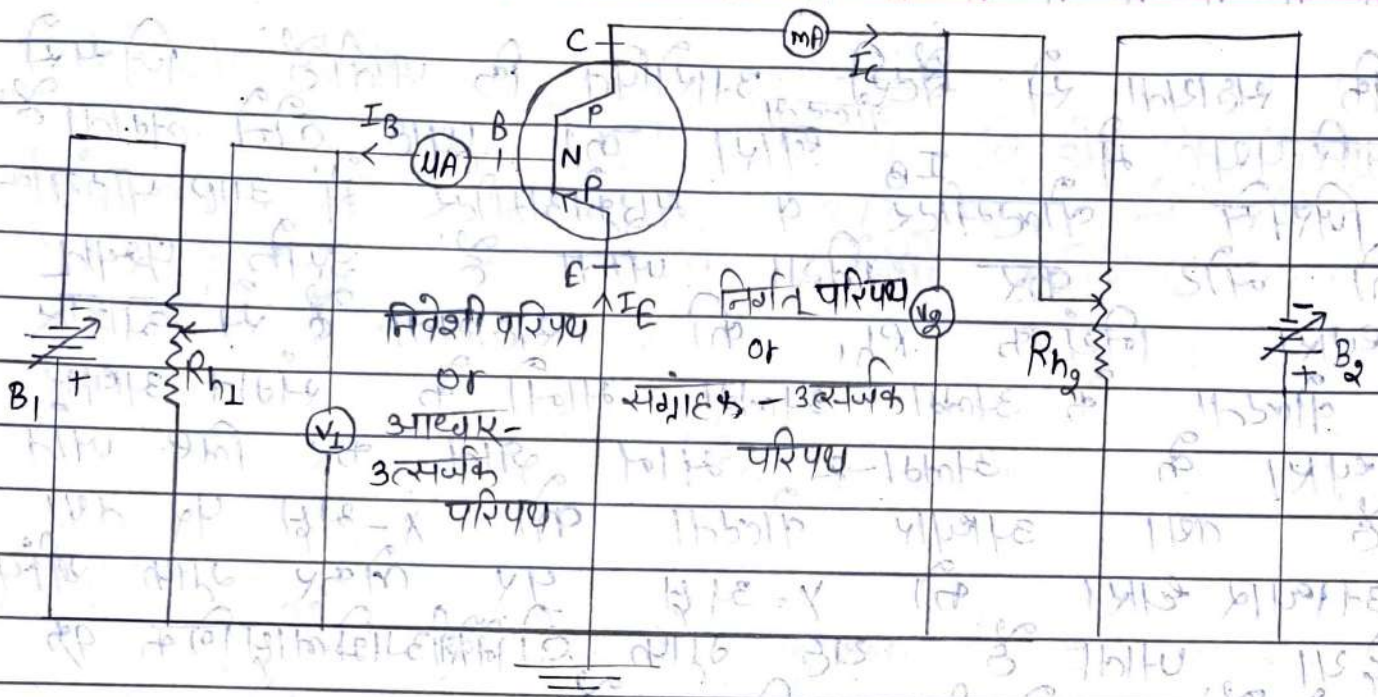
गतिक धारा लाभ -

$$\alpha = \left(\frac{\Delta I_c}{\Delta I_E} \right) V_c - \text{Const.}$$

9. अभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्र -
 जब किसी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को अभयनिष्ठ वोल्टता पर रख दिया जाता है अर्थात् भू-सम्पर्कित कर दिया जाता है तो इस प्रकार के अभिविन्यास को अभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास कहा जाता है। तथा इस अभिविन्यास के लिए निम्न दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं।

- i) निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र
- ii) निर्गत " " " "

i) निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र -
 जब किसी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को अभयनिष्ठ वोल्टता पर रखकर निर्गत परिपथ में प्राप्त संग्राहक वोल्टता को किसी निश्चित मान पर रखकर निवेशी परिपथ में प्राप्त V_B तथा I_B के मध्य खींचे गए वक्र को ही निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलते हैं,



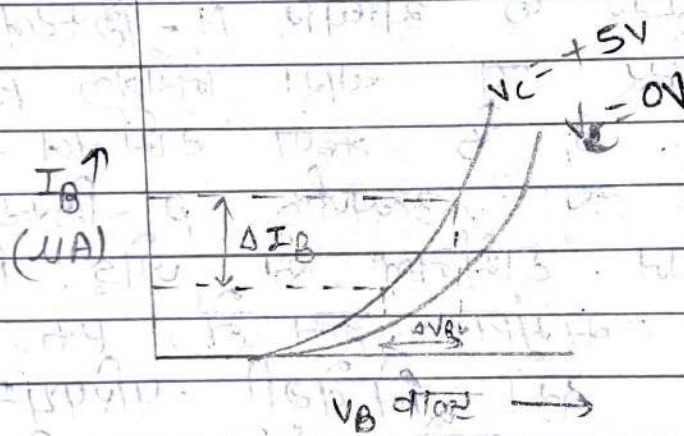
वर्णन-

PNP ट्रांजिस्टर के आधार N-क्रिस्टल के श्रेणी क्रम में μ अमीटर व धारा नियंत्रक R_{h1} जोड़ते हुए इसे बैटरी B_1 के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तथा उत्सर्जक P-क्रिस्टल को बैटरी B_1 के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तथा इसके समान्तर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा होता है इसे निवेशी परिपथ या V_E परिपथ कहा जाता है तथा इसके संग्राहक P-क्रिस्टल के श्रेणी क्रम में mA व धारा नियंत्रक R_{h2} से जोड़ते हुए इसे बैटरी B_2 के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तथा समान्तर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा होता है इसे निर्गत परिपथ या $C-E$ परिपथ कहा जाता है।

कार्यविधि -

सर्वप्रथम निर्गत परिपथ में बैटरी B_2 की सहायता से वोल्टता आरोपित की जाती है तथा संग्राहक वोल्टता को नियत मान पर रखकर निवेशी परिपथ में बैटरी B_1

कि सहायता से बैटरी आरोपित कि जाती है जिससे परिपथ में वोल्टता धारा का प्रवाह होने लगता है जिससे वोल्टमीटर व माइक्रोअमीटर में आठ पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है इसके पश्चात धारा नियंत्रक R_h की सहायता से आधार वोल्टता के अलग-अलग मानों के संगत आधार धारा के अलग-अलग मान ज्ञात कर लिए जाते हैं तथा आधार वोल्टता को x-अक्ष पर तथा आधार धारा को y-अक्ष पर लेकर ग्राफ खींच दिया जाता है यह ग्राफ ही निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है जो कि निम्न है।



निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कि विशेषताये:-

1. ग्राफ से स्पष्ट होता है कि V_{Bc} व I_B के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी सरल रेखा में प्राप्त की जाता है।
 त्नी अर्थात् यह ओम के नियम का पालन नहीं करता।
2. ग्राफ से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में I_B का मान बढ़ाने पर I_B का मान शून्य प्राप्त होता है।
 हैं लेकिन V_B को और अधिक बढ़ाने पर I_B का मान बढ़ने लगता है।

3. निवेशी प्रतिरोध -

ग्राफ में किन्ही दो बिंदुओं के मध्य वोल्टता में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही निवेशी प्रतिरोध कहा जाता है इसका मान -

$$R_i = \left(\frac{\Delta V_B}{\Delta I_B} \right)_{V_C - \text{const}}$$

4. चालकता -

निवेशी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है।

$$\sigma = \frac{1}{R_i} = \left(\frac{\Delta I_B}{\Delta V_B} \right)_{V_C - \text{const}}$$

निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र -

जब किसी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को अभयनिष्ठ वोल्टता पर रखकर निवेशी परिपथ में प्राप्त आधार धारा I_B को नियत मान पर रखकर निर्गत परिपथ में प्राप्त V_C (संग्राहक वोल्टता) तथा I_C (संग्राहक धारा) के मध्य खींचे गए ग्राफ ही निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं।

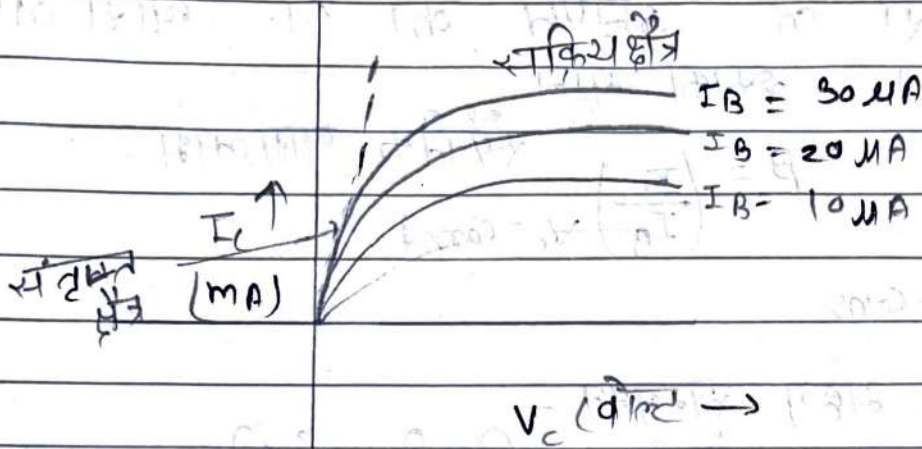
परिपथ चित्र -

notes (whatsapp) - 8696608541 (sbistudy.com)
om prakash saini

वर्णन -

कार्यविधि -

सर्वप्रथम निवेशी परिपथ में बैटरी B_1 की सहायता से सहायता से वोल्टता आरीपित की जाती है जिससे परिपथ में I_B धारा का प्रवाह होने लगता है तथा I_B धारा को एक निश्चल मान पर रखकर निश्चित परिपथ में बैटरी B_2 की सहायता से वोल्टता आरीपित की जाती है। जिससे परिपथ में I_C धारा का प्रवाह होने लगता है। जिससे वोल्टमीटर व मिलीअमीटर में आए पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है इसके पश्चात् धारा नियंत्रक R_h की सहायता से संग्राहक वोल्टता के अलावा-2 मानी के संगत संग्राहक धारा के अलावा-2 मान ज्ञात कर लिए जाते हैं इसके पश्चात् संग्राहक वोल्टता को x -अक्ष पर व I_C संग्राहक धारा को मध्य y -अक्ष पर लेकर ग्राफ खींच दिए जाते हैं जो कि निम्न है। -



निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की विशेषता -

1. ग्राफ से स्पष्ट होता है I_C व V_C के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है अर्थात् यह ओम के नियम का पालन नहीं करता।

2. ग्राफ से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में V_C का मान बढ़ाने पर I_C का मान भी बढ़ता है लेकिन कुछ ही समय में धारा I_C अपने संतृप्त मान को प्राप्त कर लेती है इसके पश्चात् V_C को बढ़ाने पर I_C का मान अपरिवर्तित रहता है।

3. निर्गत प्रतिरोध -

ग्राफ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य संग्राहक वोल्टता में परिवर्तन तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही निर्गत प्रतिरोध कहा जाता है।

$$R_o = \left(\frac{\Delta V_C}{\Delta I_C} \right)_{I_B = \text{Cons.}}$$

4. धारा लाभ -

निर्गत परिपथ में प्राप्त धारा तथा निवेशी परिपथ

में प्राप्त धारा के अनुपात को ही धारा लाभ कहा जाता है। इसका मान -
गतिक धारा लाभ - स्थैतिक धारा लाभ -

$$\beta = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right) V_C - \text{const.}$$

$$\beta = \left(\frac{I_C}{I_B} \right) V_C - \text{const.}$$

* α तथा β के मध्य सम्बन्ध -

जब किसी ट्रांजिस्टर पर बाह्य वोल्टता आरोपित की जाती है तो ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होने लगता है इस स्थिति में किरचॉफ के लूप नियम से -

$$I_E = I_B + I_C \quad \text{--- (1)}$$

धाराओं में परिवर्तन होने पर (गतिक धारा की स्थिति में)

$$\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C \quad \text{--- (2)}$$

समी. (2) में ΔI_C से भाग देने पर

$$\frac{\Delta I_E}{\Delta I_C} = \frac{\Delta I_B}{\Delta I_C} + \frac{\Delta I_C}{\Delta I_C}$$

$$\frac{\Delta I_E}{\Delta I_C} = \frac{\Delta I_B}{\Delta I_C} + 1 \quad \text{--- (3)}$$

$$\therefore \alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$$

$$\therefore \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

समी. ③ से -

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\beta} + 1 \quad \text{--- (4)}$$

समी. ④ से -

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1+\beta}{\beta}$$

$$\rho = \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right) \quad \text{--- (5)}$$

पुनः समी. 4 से -

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\beta} + 1 \quad \text{से}$$

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\rho} - 1$$

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1-\rho}{\rho}$$

$$\beta = \frac{\rho}{1-\rho}$$

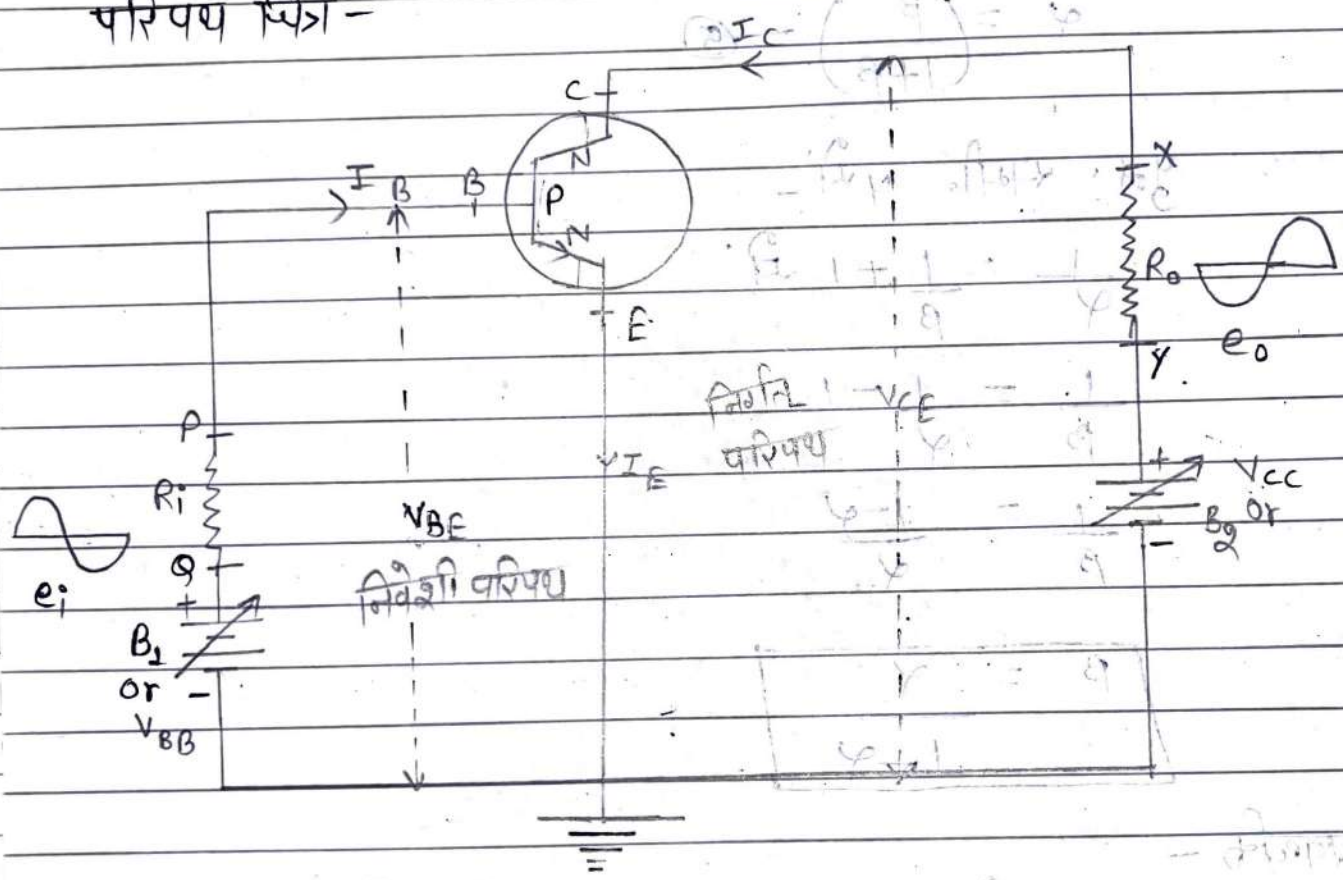
* प्रवर्धक -

वह युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती संकेत के आयाम बढ़ा दिए जाते हैं। मान्यता है कि जो भी प्रवर्धक कहलाता है तब इस प्रक्रिया को प्रवर्धन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है।

तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग भी प्रवर्धक के रूप में निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है

- i) उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए -
- ii) उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए -
- iii) उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग -

परिपथ चित्र -



व्याख्या -

जब निवेशी परिपथ में बैटरी B₁ की सहायता से वोल्टता आरोपित कि जाती जाती है तो इसमें आधार द्वारा I_B का प्रवाह होने लगता है जिससे निगति परिपथ में संग्राहक द्वारा रूपवहित होने लगती है तो इस स्थिति में निगति परिपथ में किरचॉफ के लूप नियम से -

$$V_{CC} = I_C R_o + V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad \text{--- (1)}$$

जिस प्रत्यावर्ती संकेत के आशाम या तीव्रता के मान में वृद्धि करनी है उसे निवेशी परिपथ में निवेशी प्रतिरोध R_{in} के सिरो के मध्य आरोपित किया जाता है। तब जब निवेशी परिपथ में वोल्टता के मान में वृद्धि कि जाती है अर्थात् निवेशी परिपथ को धनात्मक अर्द्धचक्र पर आरोपित किया जाता है तो इस स्थिति में निवेशी परिपथ में आधार-धारा I_B का मान बढ़ने के कारण निर्गत परिपथ में संग्राहक धारा I_C का मान भी बढ़ने लगता है। जिससे समी. (1) के अनुसार V_{CE} के मान में कमी होती है। अर्थात् वोल्टता का मान घटता है। लेकिन जब ऋण निवेशी परिपथ पर ऋणात्मक अर्द्धचक्र आरोपित किया जाता है तो धारा I_B का मान घटने से निर्गत परिपथ में I_C का मान भी घटने लगता है। जिसके कारण समी. (1) अनुसार V_{CE} के मान में वृद्धि होती है। जिसके कारण निर्गत लोड प्रतिरोध R_L के सिरो के मध्य बड़ा हुआ संकेत प्राप्त होता है।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए प्रवर्धक के रूप में काम में लिया जाता है तो इसके निवेशी संकेत तथा निर्गत संकेत के मध्य 180° का कलान्तर होता है।

* प्रवर्धक का गणितीय विश्लेषण -
ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग करते समय निम्न परिपथ में प्राप्त भौतिक राशियों तथा निवेशी परिपथ में प्राप्त भौतिक राशियों के अनुपात को ही लाभ कहा जाता है तथा यह निम्न प्रकार के होते हैं -

i) प्रतिरोध लाभ -
निर्गत परिपथ में प्राप्त प्रतिरोध तथा निवेशी परिपथ में प्राप्त प्रतिरोध के अनुपात को ही प्रतिरोध लाभ कहा जाता है।

$$A_R = \frac{R_o}{R_i}$$

ii) धारा लाभ -
निर्गत परिपथ में प्राप्त धारा तथा निवेशी परिपथ में प्राप्त धारा के अनुपात को ही धारा लाभ कहा जाता है।

$$\beta = \frac{I_c}{I_b}$$

iii) वोल्टता लाभ -
निर्गत परिपथ में प्राप्त वोल्टता तथा निवेशी परिपथ में प्राप्त वोल्टता के अनुपात को ही वोल्टता लाभ कहा जाता है। इसका मान

$$e_r = \frac{e_o}{e_i} \quad \text{--- (1)}$$

$$\therefore e = IR \text{ से}$$

$$e_r = \frac{I_c R_o}{I_b R_i}$$

$$e_r = \beta \times A_R$$

14) शक्ति लाभ -

निर्गत परिपथ में प्राप्त शक्ति तथा निवेशी परिपथ में प्राप्त शक्ति के अनुपात को ही शक्ति लाभ कहा जाता है। इसका मान -

$$P_R = \frac{P_o}{P_i} \text{ --- (1)}$$

$$\therefore P = VI \text{ से}$$

$$P_R = \frac{e_o I_c}{e_i I_B}$$

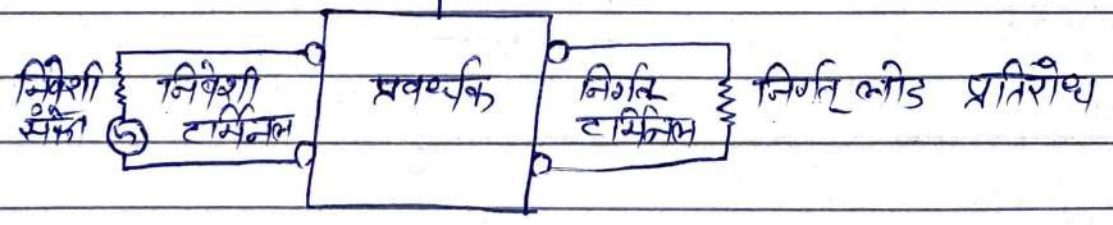
$$\therefore e = IR \text{ से}$$

$$P_R = \frac{(I_c R_o) I_c}{(I_B R_i) I_B}$$

$$P_R = \frac{I_c^2 R_o}{I_B^2 R_i}$$

Note:-
Page-48
16.44

प्रवर्धक का ब्लॉक आरेख चित्र -



* अंकित इलेक्ट्रॉनिकी -

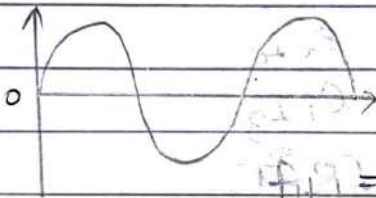
इलेक्ट्रॉनिकी में मूलतः दो प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है इन संकेतों को ही सिग्नल लिटर रूप से अंकित इलेक्ट्रॉनिकी के

नाम से जाना जाता है। यह दोनो संकेत निम्न हैं-

1. अनुरूप संकेत
2. अंकीय संकेत

1. अनुरूप संकेत-

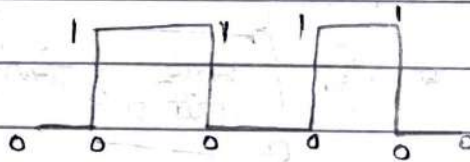
वे संकेत जो समय के सतत फलन होते हैं अर्थात् समय पर निर्भर करते हैं उन्हें अनुरूप संकेत कहा जाता है।



$$v(t) = v \sin \omega t$$

2. अंकीय संकेत-

वे संकेत जो समय के सतत फलन नहीं होते। अर्थात् जिनका मान समय पर निर्भर नहीं करता उन्हें अंकीय संकेत कहा जाता है तथा इन्हें 0 व 1 के रूप में दिखा सकते हैं।



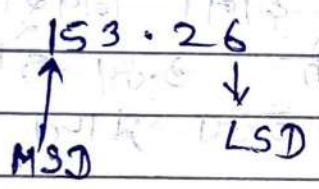
* गणना कि पद्धतियाँ-

गणना कि पद्धतियाँ निम्न दो प्रकार कि होती हैं-

1. दशमलव पद्धति
2. द्विआधारी या बाइनरी पद्धति

1. दशमलव पद्धति -

इस पद्धति में 0 से लेकर 9 के तक के अंक होते हैं। 10 अंक होने के कारण इस पद्धति को दशमलव पद्धति कहा जाता है तथा इस पद्धति का आधार भी 10 होता है। इस पद्धति में सबसे बाएँ ओर के अंक को MSD (Maximum Significant digit - अधिकतम सार्थक अंक) कहा जाता है लेकिन सबसे दाहिनी ओर के अंक को LSD (Least Significant digit - न्यूनतम सार्थक अंक) कहा जाता है।



2. द्वि-आधारी पद्धति - (बाइनरी पद्धति)

इस पद्धति में केवल दो अंक 0 व 1 होते हैं। तथा इसका आधार द्वाँदश होता है। इस कारण इस पद्धति को द्विआधारी या बाइनरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में 0 व 1 को बिट के नाम से जाना जाता है चार बिट के एक समूह निवल तथा आठ बिट के एक समूह को बाइट कहा जाता है।

* तर्क द्वार -

ये द्वार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के आधार-भूत भाग होते हैं तथा इनमें निवेशी संकेत व निर्गत संकेत के मध्य एक तार्किक संबंध पाया जाता है। तथा यह तर्क द्वार

निम्न होते हैं -

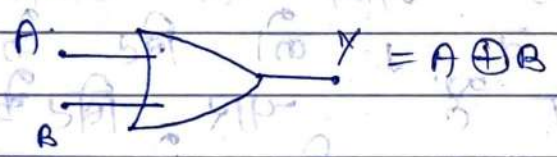
1. OR Gate
 2. AND Gate
 3. NOT Gate
 4. NOR Gate
 5. NAND Gate
 6. XOR Gate
- } universal gate (सार्वत्रिक तर्क द्वार)

OR Gate:- इस तर्क द्वार में दोनों निवेशी संकेतों में से किसी एक निवेशी संकेत के उच्च होने पर निगमित संकेत का मान उच्च प्राप्त होता है।

ii) बुलीय व्यंजक

$$Y = A \oplus B = A + B$$

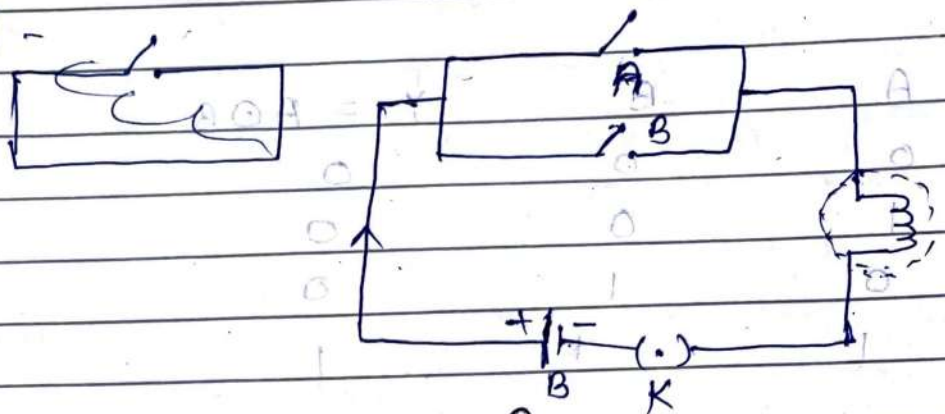
iii) प्रतीक चिह्न



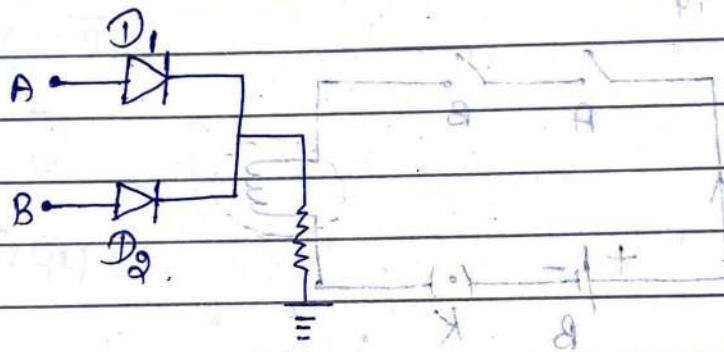
iv) सत्यता सारणी -

| A | B | $Y = A \oplus B$ |
|---|---|------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

v) स्विचिंग परिपथ -



vi) डायोड युक्त या जंशोड पर आधारित OR Gate: -

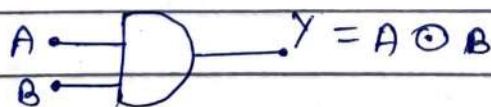


ii) AND Gate :- इस तक द्वारमें दोनों निवेशी संकेतों के उच्च होने पर ही निगति संकेत भी उच्च प्राप्त होता है।

iii) बुलीय व्यंजक -

$$Y = A \odot B$$

iv) प्रतीक चिन्ह -



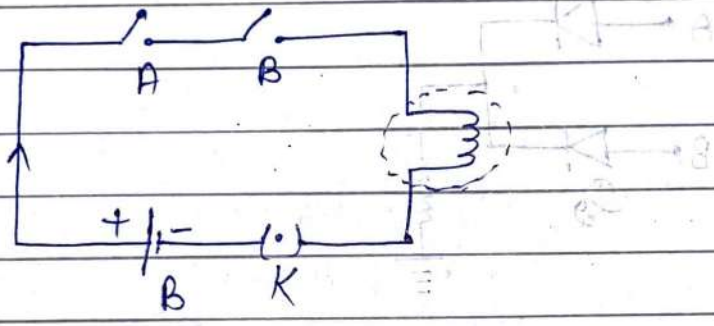
v) सत्यता सारणी -

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

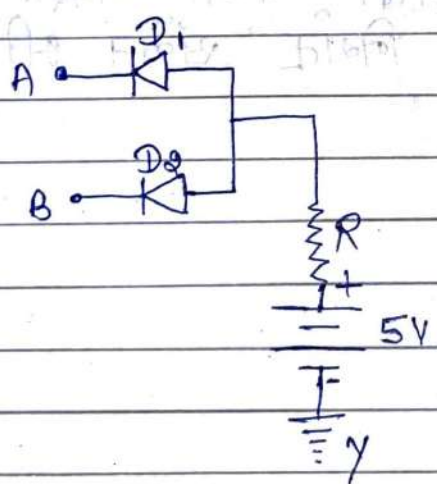
iv)

| A | B | $Y = A \odot B$ |
|---|---|-----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

v) स्वचिंता परिपथ -



vi) डायोड पर आधारित AND Gate :-



3. NOT Gate:- इस तर्क द्वारमें केवल एक निवेशी संकेत होता है निरति संकेत के रूप में इस निवेशी संकेत का व्युत्क्रम प्राप्त होता है।

ii) बुलियन व्यंजक -

$$Y = \bar{A}$$

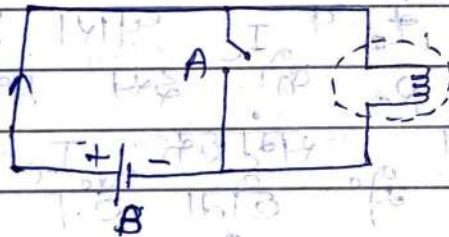
iii) प्रतीक चिन्ह -



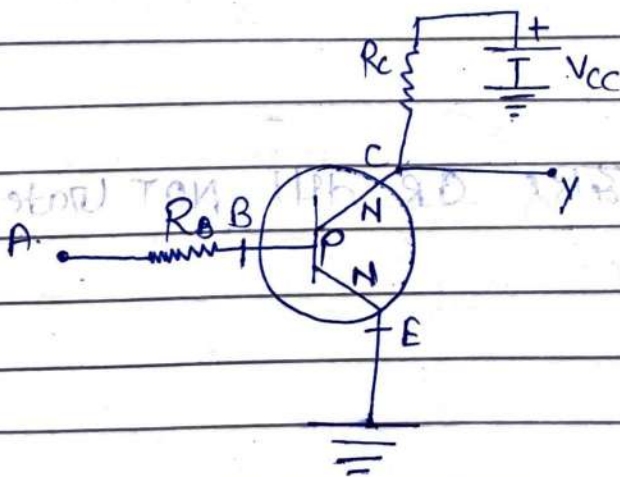
iv) सत्यता सारणी -

| A | $Y = \bar{A}$ |
|---|---------------|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

v) खिचिंग परिपथ -



vi) ट्रांजिस्टर पर आधारित NOT Gate: -



NOT Gate प्रदर्शित चित्र में NPN ट्रांजिस्टर के आधार पर दर्शाया गया है। इस स्थिति में निवेशी संकेत A को जब ग्राउंड-सम्पर्कित किया जाता है अर्थात् 0 की स्थिति में रखा जाता है तो उत्सर्जक पहले से ही ग्राउंड-सम्पर्कित होता है तथा संग्राहक आधार संधि उत्क्रम वायस पर कार्य करती है। इस स्थिति में I_A , I_B व I_C तीनों धारायें शून्य होती हैं जिसके कारण ट्रांजिस्टर अन्तःक अवस्था में अपस्थित होता है। तथा इस स्थिति में पृथ्वी के सापेक्ष विभव का मान प्राप्त होता है जिससे निर्गत संकेत $Y = 1$ होता है।

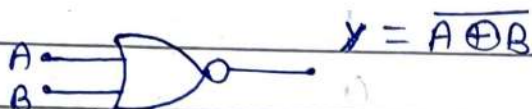
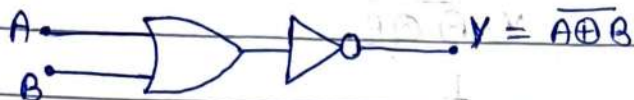
जब निवेशी संकेत को पृथ्वी के सापेक्ष +5 Volt अर्थात् $A = 1$ पर रखा जाता है तो E-B संधि अग्रवायस पर कार्यरत होने के कारण परिपथ में I_E , I_B व I_C धारा प्रवाहित होती हैं। इस स्थिति में R_B व R_C को इस प्रकार उपयोग में लिया जाए तो संग्राहक I_C उच्च हो ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में होता है। जिसके कारण R_C के सिरी पर वोल्टता पतन ठीक उतना व विपरित होगा जो बैटरी के कारण उत्पन्न होता है। अतः इस स्थिति में कोई निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होगा।

4. NOR Gate :- यह लॉक द्वार OR तथा NOT Gate से मिलकर बना होता है।

ii) बुलीय व्यंजक -

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

iii) प्रतीक चिन्ह -



iv) सत्यता सारणी -

| A | B | $A \oplus B$ | $Y = \overline{A \oplus B}$ |
|---|---|--------------|-----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

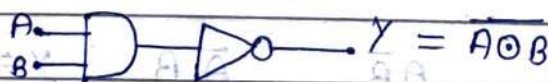
5. NAND Gate:-

यह एक द्वार है जो AND तथा NOT Gate से मिलकर बना होता है।

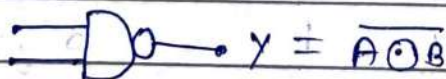
ii) बुलीय व्यंजक -

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

iii) प्रतीक चिन्ह -



or



iv) सत्यता सारणी -

| A | B | $A \odot B$ | $Y = \overline{A \odot B}$ |
|---|---|-------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

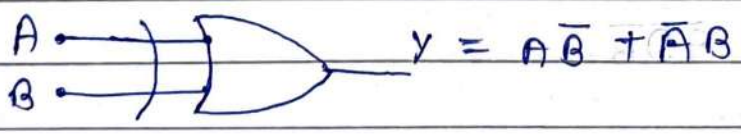
6. XOR Gate:-

इस तर्क द्वार में निर्गत संकेत उच्च अवस्था में केवल तभी प्राप्त होता है जब दोनों निवेशी संकेतों में से कोई एक उच्च अवस्था में है।

ii) बुलीय व्यंजक -

$$Y = A\bar{B} + \bar{A}B \quad (Y = A \oplus B)$$

iii) तर्क चिन्ह -



iv) सत्यता सारणी -

| A | B | \bar{A} | \bar{B} | $A\bar{B}$ | $\bar{A}B$ | $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$ |
|---|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Note:- i) NOR gate तथा NAND gate सार्वत्रिक तर्क द्वारक होते हैं।

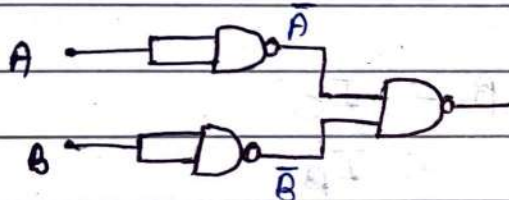
ii) $y = \overline{\overline{A + B}} = A \cdot B$

$y = \overline{\overline{A \cdot B}} = A + B$

$y = \overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$

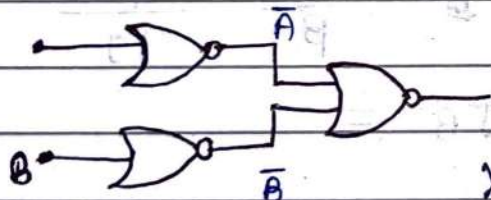
$y = \overline{\overline{A + B}} = A + B$

Q.



$y = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$

Q.



$y = \overline{\overline{A + B}} = A \cdot B$

* ऐवनांश मंजन -

जब pN संधि डायोड की उत्क्रम वाद्यस पर प्रचालित किया जाता है तो इस स्थिति में p तथा N क्रिस्टल में उपस्थित अल्पसंख्यक होल या कॉटर p-क्रिस्टल कि ओर गमन करते हैं जिसके कारण ये p-क्रिस्टल में पहुँचकर होल या कॉटरों के साथ टक्कर करते हैं जिससे इनके मध्य बने बंध टूट जाते हैं। जिसके कारण आवेश वाहको कि संख्या में तेजी से

बृद्धि होती है जिससे इस स्थिति में प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है इस प्रक्रिया को ही ऐवलांश कृष्णन के नाम से जाना जाता है।

18.4.

$R_f = 25 \Omega$

$\Delta V = ? , \Delta I = 1 \text{ mA}$

Solu" $R_f = \frac{\Delta V}{\Delta I}$

$25 = \frac{\Delta V}{1 \times 10^{-3}}$

$\Delta V = 25 \times 10^{-3}$

$\Delta V = 25 \text{ mV}$

$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

$\beta = \frac{0.95}{1-0.95} = \frac{0.95}{0.05}$

$\beta = 19$

$\beta = \frac{I_c}{I_b}$

16.5. $\alpha = \frac{I_c}{I_E} = 0.99$

$I_B = \frac{I_c}{\beta} = \frac{1 \times 10^{-3}}{19}$

Solu" $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

$\beta = \frac{0.99}{1-0.99} = \frac{0.99}{0.01}$

$\beta =$

16.7. $\Delta V_{EB} = 5 \text{ mV}$

$\Delta I_E = 0.5 \text{ mA}$

$R_i = ?$

16.6. $R = 2 \text{ k}\Omega , V = 2 \text{ V}$

$\alpha = 0.95 , I_B = ?$

Solu" $I_c = \frac{V}{R} \times \alpha$

$I_c = 1 \times 10^{-3} \text{ A} = 1 \text{ mA}$

Solu"

$R_i = \frac{\Delta V_{EB}}{\Delta I_{EB}} = \frac{5 \times 10^{-3} \times 100}{0.5 \times 10^{-3}}$

$R_i = \frac{100}{3} \Omega$

objective.

$\underline{16.8} \cdot \Delta I_B = 20 \mu A$
 $\Delta I_C = 1 mA$
 $\Delta V_{BE} = 0.04 V$

$\underline{Q.3} \cdot n_i = 1.6 \times 10^{16} / m^3$
 $\mu_e = 0.150 m^2 / V \cdot sec$
 $\mu_h = 0.05 \times m^2 / V \cdot sec$

Solu.

i) $R_i = \frac{\Delta V_B}{\Delta I_B}$

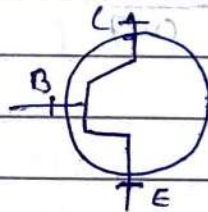
$R_i = \frac{0.04}{20 \times 10^{-6}}$

$R_i = \frac{0.04 \times 10^6}{20}$

$R_i = \frac{40^2}{20} \times 10^3 = 2000 \Omega$

$\sigma = ?$

Solu. $\sigma = n_i q_e (\mu_e + \mu_h)$

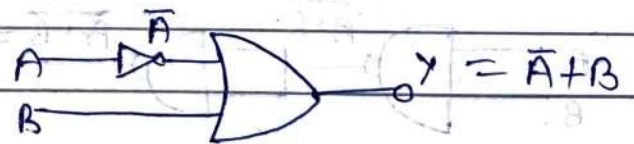


$\underline{40}$

ii) $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{1 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}}$

$\beta = \frac{10^3}{20} = 50$

$\underline{50}$



iii) $R_c = 6 K \Omega$

$e_r = \frac{e_o}{e_i} = \frac{I_c R_c}{I_B R_i}$

$e_r = \frac{1 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^3}{20 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^3}$

$e_r = \frac{3 \times 10^3}{20}$

$e_r = 150$

$\underline{70} \cdot \alpha = 0.95$

$I_E = 2 mA$

$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$

$0.95 = \frac{I_C}{2 \times 10^{-3}}$

2×10^{-3}

$$I_C = 0.95 \times 2 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$E = 6 \text{ V}$$

$$\therefore I_E = I_B + I_C \text{ सही}$$

$$\text{solu' } I = \frac{E}{R} = \frac{6}{300}$$

$$I_B = I_E - I_C$$

$$\text{Q.3. } \alpha = 0.99, \Delta I_E = 5 \text{ mA}$$

$$\Delta I_C = ?$$

$$\Delta I_B = ?$$

$$\text{Q.8. } E = 0.7 \text{ eV}$$

$$E = 0.7 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\therefore E = \frac{hc}{\lambda} \text{ सही}$$

$$\text{solu'' } \alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{1240}{0.7}$$

$$0.99 = \frac{\Delta I_C}{5 \times 10^{-3}}$$

$$\Delta I_C = 0.99 \times 5 \times 10^{-3}$$

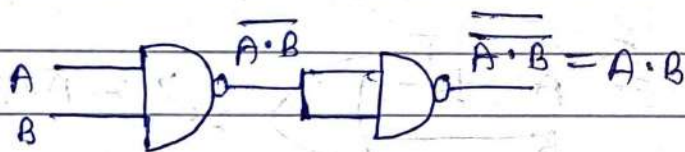
$$\Delta I_C = 4.95 \times 10^{-3}$$

Q.

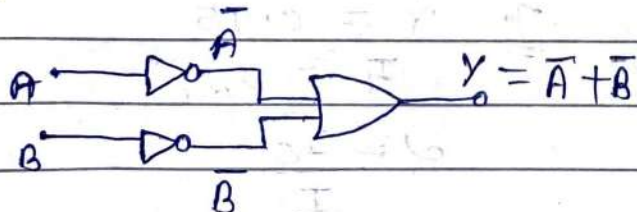


$$\Delta I_E = \Delta I_C + \Delta I_B$$

$$\Delta I_B = \Delta I_E - \Delta I_C$$



मध्य



4.

$$V = 0.1 \text{ Volt}$$

$$E = 10^5 \text{ V/m}$$

$$d = ?$$

अंकि Q. Q.2 $R = 150 + 50 \parallel 100$

$$R = 300 \Omega$$

$$\text{solu'' } V = E \times d \text{ सही}$$

$$V = E \times d$$

$$d = \frac{V}{E} = \frac{0.1}{10^5}$$

$$d = 0.1 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta I_E = 10^{-3} [0.050 + 1]$$

Q.5. $V_C = 8 \text{ V}$, $R_C = 800 \Omega$

$$V = 0.5 \text{ V}, \quad \eta = 0.96$$

$$I_B = ?$$

Solu शीघ्र वोल्टता -

$$V = 8 - 0.5 = 7.5 \text{ V}$$

$$\therefore I_C = \frac{V_C}{R_C} = \frac{7.5}{800}$$

$$I_C = \frac{7.5 \times 10^{-2}}{8} =$$

$$\eta = \frac{I_C}{I_E}$$

$$I_E = \frac{I_C}{\eta} = \frac{7.5 \times 10^{-2}}{8 \times 0.96}$$

$$I_E = 9$$

$$\therefore I_E = I_B + I_C \text{ से।}$$

$$I_B = I_E - I_C$$

Q.6. $\Delta I_B = 50 \mu\text{A}$

$$\Delta I_C = 1 \text{ mA}$$

$$\beta = ? , \quad \eta = ? , \quad \Delta I_E = ?$$

Solu $\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C$

$$\Delta I_E = 50 \times 10^{-6} + 1 \times 10^{-3}$$

$$\Delta I_E = 10^{-3} [50 \times 10^{-3} + 1]$$

धारा $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} = \frac{1}{1.050}$

$$\eta = \frac{\beta}{1 + \beta} =$$

70 $R_L = 2 \text{ k}\Omega$

$$V_Z = 15 \text{ Volt}$$

$$I_{\text{min}} = 10 \text{ mA}$$

Solu $I = \frac{V_Z}{R}$ से।

$$I_2 = \frac{15}{2 \times 10^3}$$

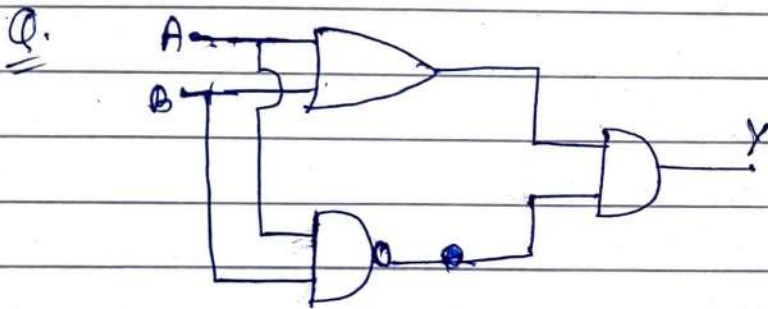
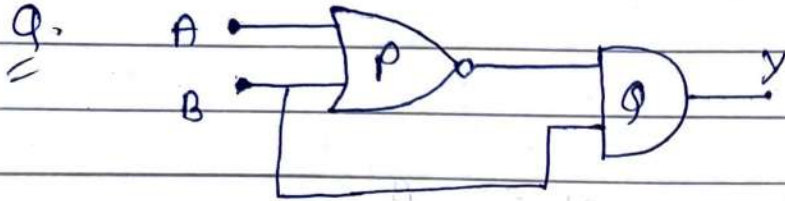
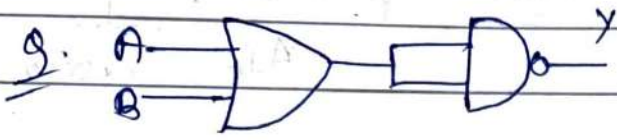
$$I_2 = 7.5 \times 10^{-3} = 7.5 \text{ mA}$$

कुल प्रवाहित धारा -

$$I = 10 + 7.5$$

$$I = 17.5 \text{ mA}$$

Q. दुभय व्यंजक व सत्यता सारणी लिखो ?



notes (whatsapp) - 8696608541 (sbistudy.com)
om prakash saini